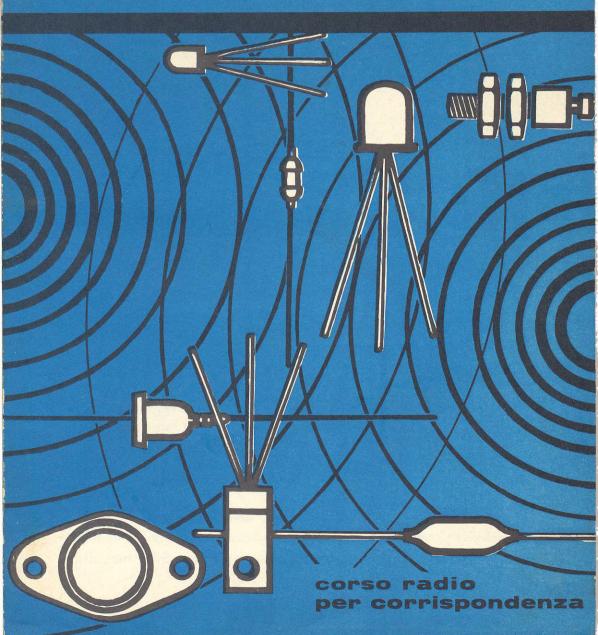
dati transistori



Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5 - Torino



(41 RS'.

PREMESSA

Il presente prontuario riassume i dati tecnici piú importanti che caratterizzano il maggior numero possibile dei transistori di tipo europeo, usati particolarmente in campo radio e TV.

Ciò allo scopo di fornire al tecnico riparatore ed a chi si dedica alla realizzazione di apparecchiature sperimentali una guida utile e di facile consultazione per l'identificazione delle principali caratteristiche elettriche e meccaniche dei transistori di tipo più corrente.

I dati raccolti in questo prontuario hanno naturalmente scopo essenzialmente di orientamento.

Coloro che, dedicandosi alla progettazione di apparecchiature, necessitino di informazioni tecniche più dettagliate, potranno richiedere i manuali editi dalle case costruttrici dei semiconduttori.

1. - ELENCO E DEFINIZIONI DEI SIMBOLI DEL PRESENTE PRONTUARIO

f : frequenza

fβ : frequenza di taglio del guadagno di corrente con uscita in corto-

circuito (montaggio ad emettitore comune)

f_T : frequenza di transizione G_p : guadagno di potenza

Gtr : guadagno di trasduzione di potenza
GUM : guadagno di potenza unilateralizzato

h_{FE} : guadagno statico di corrente (emettitore comune)

I_C : corrente di collettore P : potenza dissipata

R_{BE}: resistenza esterna base-emettitore

Rtha : resistenza termica fra la giunzione e l'ambiente (transistore in aria

libera)

Rthc : resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore

Ta : temperatura ambiente

T_C : temperatura del contenitore
 T_i : temperatura della giunzione

toff : tempo di commutazione in apertura ton : tempo di commutazione in chiusura V_{CBO} : tensione collettore-base (emettitore aperto)

V_{CBO} : tensione collettore-base (emet V_{CE} : tensione collettore-emettitore

V_{CEO}: tensione collettore-emettitore (base aperta)

V_{CER}: tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore chiusa

su un dato resistore RBE)

V_{CES} : tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore in corto-

circuito)

V_{CEX}: tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore polariz-

zata in senso inverso)

yfe : ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; mon-

taggio ad emettitore comune)

yfb : ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; mon-

taggio a base comune)

β : guadagno di corrente dinamico (uscita in cortocircuito; montaggio

ad emettitore comune).

2. - ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI USATE

alim. alimentazione amplificatore ampl. commutazione commut. = compl. complementare contenitore cont. conv. convertitore diss. dissipatore orizz. orizzontale oscill. oscillatore

preampl. = preamplificatore sincr. = sincronizzazione

vert. = verticale.

3. - COME CONSULTARE IL PRONTUARIO

Al fine di consentire una ricerca agevole e rapida, i transistori sono stati riportati seguendo un ordine alfabetico.

Per ciascun transistore sono riportati i dati più importanti, ripartiti sostanzialmente in cinque colonne; nella testata orizzontale in alto si trova, incominciando da sinistra:

- 1) la sigla del transistore;
- 2) la struttura, ossia se è PNP o NPN e, immediatamente sotto, il tipo di contenitore; le connessioni relative sono riportate nelle ultime pagine del Prontuario (Dati Transistori 2);
- l'applicazione tipica per la quale è stato particolarmente studiato (per ragioni di spazio si sono adottate le numerose abbreviazioni sopra specificate):
- 4) i valori massimi assoluti:
- 5) i dati elettrici caratteristici.

Tutte le grandezze sono indicate con le rispettive unità di misura.

ossia:

E' bene fare subito una distinzione fra i valori massimi assoluti e le caratteristiche elettriche.

I valori massimi assoluti sono valori limite superati i quali il semiconduttore può danneggiarsi in modo permanente.

Questi limiti dipendono dalle caratteristiche proprie del semiconduttore e vengono quindi stabiliti dal costruttore.

Trattandosi di valori massimi assoluti, devono essere considerati come le estreme possibilità del dispositivo. Le condizioni normali di progetto devono rimanere molto al di sotto di questi valori, che non devono neanche essere raggiunti durante le peggiori condizioni di funzionamento che si possano presentare.

Le caratteristiche elettriche, al contrario, mettono in risalto i parametri più importanti del semiconduttore ed esprimono una proprietà tipica, in una specifica condizione di misura, per la quale il semiconduttore consente prestazioni ripetibili.

Dopo queste precisazioni, possiamo ora esaminare il significato e l'esatta interpretazione dei dati riportati.

4. · VALORI MASSIMI DI TENSIONE E DI CORRENTE

Sono riportati i valori delle tensioni inverse di rottura applicate alle giunzioni collettore-base e collettore-emettitore. Il valore massimo di tensione V_{CBO} corrisponde alla tensione inversa di rottura della giunzione collettore-base (con emettitore aperto).

La tensione di rottura della giunzione collettore-emettitore interessa invece due giunzioni: la giunzione collettore-base, polarizzata sempre in senso inverso, e la giunzione emettitore-base che al contrario può essere aperta, chiusa su un determinato resistore R_{BE}, chiusa in cortocircuito, oppure polarizzata in senso inverso con una determinata tensione.

A queste quattro condizioni corrispondono tensioni di rottura di valore progressivamente crescente, indicate rispettivamente con i simboli V_{CEO} ; V_{CER} ; V_{CES} : V_{CEX} .

La corrente di collettore l_C indicata rappresenta il valore massimo, da non superare, per evitare di danneggiare il transistore.

AVVERTENZA: tutti i valori massimi di tensione e di corrente riportati sul presente prontuario sono espressi solo numericamente, ossia essi si intendono, ovviamente, negativi per i transistori PNP e positivi per i transistori NPN.

5. - VALORI MASSIMI DI POTENZA E DI TEMPERATURA

Ciascun transistore è caratterizzato da una temperatura di giunzione massima T_{jmax} , superata la quale esso si danneggia.

La temperatura di giunzione Tj di un transistore dipende da tre variabili:

la temperatura ambiente T_a la dissipazione di collettore P la resistenza termica R_{tha}

secondo la relazione

$$T_i = T_a + R_{tha} \cdot P$$
.

Esaminiamo brevemente il significato di queste tre grandezze.

La temperatura ambiente T_a è la temperatura dell'ambiente in cui si trova il transistore, la quale può essere anche relativamente alta a causa del calore prodotto da resistori o transistori di potenza che si trovino nelle immediate vicinanze del transistore considerato.

La potenza P è quella dissipata sul collettore; per un amplificatore in classe A, è data da:

$$P = V_{CE} \cdot I_{C}$$

dove

V_{CE} è la tensione continua collettore-emettitore;

I_C è la corrente continua di collettore, nelle normali condizioni di funzionamento.

Come accade per qualsiasi resistore, l'energia corrispondente alla potenza P dissipata dal transistore viene trasformata, per effetto Joule, in energia termica. Ciò determina un aumento della temperatura di giunzione, che si porta ad un valore più alto di quello della temperatura Ta. Questo aumento è tanto maggiore quanto più elevata è la potenza dissipata.

La resistenza termica Rtha è un coefficiente termico, denominato "resistenza termica giunzione-ambiente", tipico di ciascun transistore, che indica di quanti gradi centigradi aumenta la temperatura della giunzione per ogni watt di potenza dissipato sul collettore.

In pratica si può dire che la resistenza termica R_{tha} definisce l'attitudine del transistore considerato a cedere all'ambiente esterno, attraverso il proprio contenitore, il calore prodotto nel suo interno a causa della potenza dissipata.

In corrispondenza della massima temperatura di giunzione T_{jmax} ammessa, si otterrà dunque la massima potenza P_{max} che il transistore può dissipare, secondo la relazione:

$$P_{max} = \frac{T_{jmax} - T_a}{R_{rha}}.$$

Questa formula consente quindi di calcolare la massima potenza che un transistore, supposto in aria libera, può dissipare.

Tenendo presente quanto detto precedentemente a proposito della resistenza termica R_{tha}, è intuitivo che, aumentando la superficie del contenitore, ad esempio corredandolo di un dissipatore termico o di alette di raffreddamento, è possibile aumentare la massima potenza dissipabile. In questo caso la resistenza termica giunzione-ambiente R_{tha} può essere più convenientemente considerata la somma di due parti e cioè:

$$R_{tha} = R_{thc} + R_{thd}$$

dove

R_{thc} è la resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore;

Rthd è la resistenza termica del dissipatore (o più precisamente fra il dissipatore e l'ambiente).

Dopo questa spiegazione preliminare, possiamo esaminare ora i dati riportati sul presente manuale.

Il valore di potenza P indicato è quello massimo che il transistore può dissipare in aria libera, cioè senza alette di raffreddamento; esso è normalmente riferito ad una temperatura $T_a = 25$ °C, salvo i casi in cui è specificato espressamente un valore di T_a diverso.

Si può osservare in ogni caso che è sempre possibile calcolare la potenza massima $P_{\rm X}$, dissipabile in aria libera ad una temperatura ambiente di valore qualsiasi $T_{\rm ax}$, applicando la seguente formula:

$$P_{X} = P \cdot \frac{T_{j} + T_{aX}}{T_{j} - T_{a}}$$

dove

P è la potenza massima riferita alla temperatura ambiente Ta;

T; è la temperatura massima della giunzione:

 T_{ax} è la temperatura ambiente in corrispondenza della quale si vuole calcolare la potenza P_x :

Ta è la temperatura ambiente, letta sulla tabella, per la quale si ottiene la potenza nota P.

ESEMPIO

•

Per il transistore AC116 sono riportati i seguenti dati:

$$P = 145 \text{ mW}$$
 $T_j = 90 \text{ °C}$

Poiché non è indicato uno specifico valore di T_a , si intende che questa potenza è valida per una temperatura ambiente $T_a = 25$ °C.

Supponiamo ora di voler conoscere la potenza massima P_X che il transistore AC116 è ancora in grado di dissipare ad una temperatura ambiente $T_{ax} = 45$ °C.

Applicando la formula 3) si trova:

$$P_{x} = P \cdot \frac{T_{j} - T_{ax}}{T_{j} - T_{a}} = 145 \cdot \frac{90 - 45}{90 - 25} = 145 \cdot \frac{45}{65} = \frac{6.525}{65} \approx 100 \text{ mW}.$$

La potenza massima che il transistore AC116 può dissipare a temperatura ambiente T_{ax} = 45 °C risulta dunque di soli 100 mW.

In altri casi il valore massimo di potenza P indicato sui dati è riportato in funzione, oltre che della temperatura Ta, di una specifica aletta per il raffreddamento o per il fissaggio su un dissipatore di calore, le cui caratteristiche sono espressamente chiarite.

Alcuni tipi di alette, di tipo standard, sono state numerate e le loro dimensioni sono riportate al termine del Prontuario (Dati Transistori 2).

In molte situazioni pratiche, essendo nota la resistenza termica giunzione-contenitore R_{thc} e fissata la temperatura ambiente di funzionamento T_a, è opportuno conoscere qual è la resistenza termica del dissipatore di calore R_{thd}, necessario perché la temperatura di giunzione non superi il limite assoluto T_{jmax}.

In questo caso, si calcola dapprima la resistenza termica Rtha con la formula:

$$R_{tha} = \frac{T_j - T_a}{P}$$

Nota dai dati la resistenza termica Rthc, tenendo presente la relazione 2) si potrà trovare poi la resistenza termica del dissipatore Rthd, data da:

ESEMPIO

Siano $T_j = 125 \, ^{\circ}\text{C}$ la temperatura massima della giunzione $T_a = 60 \, ^{\circ}\text{C}$ la temperatura massima ambiente $P = 1 \, W$ la potenza massima da dissipare

Applicando la formula 4) si ottiene:

$$R_{tha} = \frac{T_j - T_a}{P} = \frac{125 - 60}{I} = 65 \text{ °C/W}.$$

Se la resistenza termica giunzione-contenitore è R_{thc} = 50 °C/W, la resistenza termica del dissipatore R_{thd} dovrà essere:

$$R_{thd} = R_{tha} - R_{thc} = 65 - 50 = 15 \text{ °C/W}$$

(nel caso particolare in cui il dissipatore dovesse essere elettricamente isolato dal contenitore del transistore, mediante opportuna rondella isolante, occorrerà tener conto anche della resistenza termica di contatto fra contenitore e dissipatore. In pratica, al valore di Rthd calcolato nel modo su

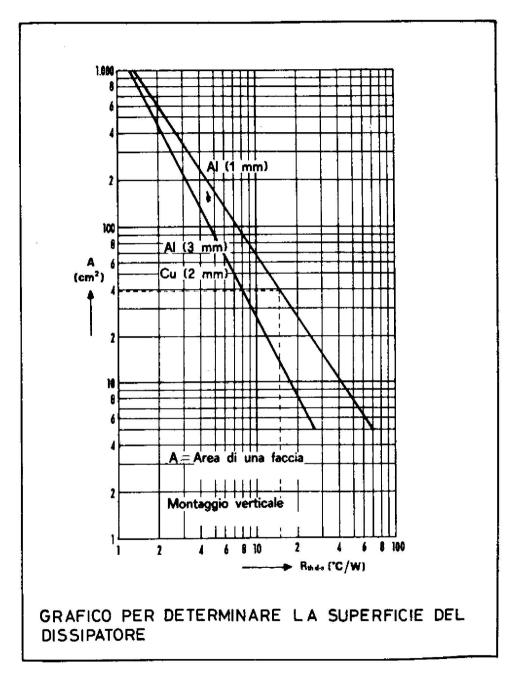


Fig. 1

indicato potrà essere sottratto un valore di resistenza termica compreso fra 0,2 e 1 °C/W).

Nota la resistenza termica del dissipatore, la sua superficie può essere trovata mediante il grafico della fig. 1.

Per l'esempio considerato, in corrispondenza di $R_{thd} = 15$ °C/W si trova 39 cm², che è la superficie del dissipatore di calore di alluminio (spesso 1 mm) necessario per il raffreddamento del transistore.

Il dissipatore deve avere preferibilmente forma quadrata. Nel caso di forma rettangolare, la lunghezza del lato piú corto deve essere almeno due terzi di quella del lato maggiore.

Sovente, infine, nel caso di transistori di grande potenza, il valore limite di dissipazione indicato dal costruttore è quello massimo teorico, corrispondente all'impiego di un dissipatore infinitamente grande, di modo che la sua temperatura coincida praticamente con la temperatura ambiente.

Ne risulta che, in tali condizioni ipotetiche, la resistenza termica giunzione-ambiente è identica alla resistenza termica giunzione-contenitore $(R_{tha} = R_{thc})$.

Sui dati riportati è precisata, in questi casi, la temperatura massima ammessa del contenitore T_c , per la quale si ha, con dissipatore infinito, il valore di potenza massimo, dato da:

$$P_{max} = \frac{T_{jmax} - T_c}{R_{thc}}.$$

Si fa presente che questo valore di potenza è puramente teorico, non essendo realizzabile in pratica un dissipatore infinitamente grande. La potenza che il transistore potrà dissipare in condizioni reali di funzionamento sarà sempre inferiore.

Questo modo di indicare la potenza, che sembra a prima vista non essere utile in pratica, serve invece per fare il calcolo senza tener conto del tipo di aletta che verrà usato.

Infatti, dare la P_{max} è come indicare la resistenza giunzione-contenitore essendo:

$$R_{thc} = \frac{T_j - T_c}{P_{max}}$$

Ottenuto questo valore, se si conosce la resistenza termica Rthd del dissipatore che si intende adottare, si può calcolare la resistenza termica giunzione-ambiente Rtha con la relazione:

In base al valore di R_{tha} cosí calcolato si può risalire con la formula 1) al valore massimo reale di potenza dissipabile in funzione della temperatura ambiente T_a e del dissipatore prescelto. Diversamente, nota la potenza che il transistore deve dissipare e la temperatura ambiente, si calcola il valore della resistenza termica giunzione-ambiente R_{tha} con la relazione 4) e si procede poi come già visto in precedenza per determinare le dimensioni del dissipatore da usare.

6. - DATI ELETTRICI CARATTERISTICI

Le proprietà elettriche dei transistori possono essere rappresentate sotto forma di quantità numeriche, dette PARAMETRI, le quali indicano le relazioni esistenti tra le tensioni e le correnti all'ingresso ed all'uscita.

Sul prontuario sono stati riportati i parametri che di solito interessano di più, e che ora saranno brevemente descritti.

L'amplificazione statica di corrente h_{FE} (connessione ad emettitore comune) è il rapporto:

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}$$

per specificati valori di corrente IC e di tensione VCE; poiché la dipendenza

dalla tensione V_{CE} è piccola, talvolta il valore di h_{FE} è dato solo in funzione di I_{C} .

Il guadagno di corrente statico $h_{\rm FE}$ è indicativo dell'attitudine del transistore ad amplificare le frequenze molto basse, ed in tale campo la sua dipendenza dalla frequenza può ritenersi trascurabile.

L'amplificazione dinamica (cioè in corrente alternata) di un transistore nella connessione ad emettitore comune è definita invece dal parametro β , che indica il rapporto tra la variazione della corrente di collettore (per tensione di collettore costante) e la variazione corrispondente della corrente di base che l'ha provocata.

Il valore di β riportato sul prontuario è riferito alla frequenza convenzionale di 1 kHz.

Sovente un dato tipo di transistore viene suddiviso dal costruttore in diverse classi di guadagno (sia statico sia dinamico), contraddistinte con numeri, lettere o punti colorati; per ciascuna classe sono stati riportati, in questi casi, o il valore tipico o i valori minimo e massimo del guadagno (hfe oppure β) corrispondente per specificati valori di I_C e V_{CE} .

Il guadagno di corrente dinamico β , sensibilmente costante per le frequenze basse, decresce invece rapidamente con le frequenze alte.

La frequenza di taglio f β è la frequenza a cui il guadagno di corrente dinamico β è sceso al 70,7 % del valore a 1 kHz.

La frequenza di transizione f_T , detta anche prodotto guadagno-ampiezza di banda, è invece la frequenza a cui il guadagno di corrente dinamico β raggiunge l'unità.

La frequenza di taglio $f\beta$ e la frequenza di transizione f_T sono legate approssimativamente dalla seguente relazione:

$$f_T = \beta \cdot f\beta$$

dove β è il guadagno a 1 kHz ad emettitore comune.

Per definire il comportamento di un transistore amplificatore in alta frequenza si riportano i valori del guadagno di potenza, che può essere espresso in diversi modi, a seconda delle condizioni di lavoro e delle condizioni circuitali in cui si trova il transistore.

Il guadagno di potenza Gp è definito come il rapporto fra la potenza trasferita al carico e la potenza in ingresso: esso è, per dati parametri, funzione solo dell'impedenza del carico ed è indipendente da quella del generatore.

Il guadagno di potenza Gtr è il guadagno dato dal rapporto fra la potenza trasferita al carico e la potenza disponibile dal generatore di ingresso; esso quindi dipende sia dall'impedenza del generatore che dall'impedenza del carico.

Il guadagno massimo di potenza G_{UM} invece è il guadagno dato come rapporto fra la potenza in uscita e quella di ingresso, nelle condizioni di carico perfettamente adattato e circuito neutralizzato con rete passiva senza perdita.

L'ammettenza di trasferimento indicata y fe (connessione ad emettitore comune) o y fb (connessione a base comune), infine, definisce praticamente la transconduttanza del transistore, cioè il rapporto fra la variazione della corrente di uscita I_C e la corrispondente variazione della tensione di ingresso V_{BE} .

Questo parametro è funzione delle condizioni di lavoro e soprattutto della frequenza f di funzionamento.

Si fa presente che i valori di tensione V_{CE} e di I_{C} riportati sul prontuario, quando è riportato il parametro y_{fb} , sono da intendersi rispettivamente V_{CB} ed I_{E} .

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS {T _a = 25 °C			TTEF a = 2	RISTICHE 5 °CI	а	lc (mA)	V _{CE}
	PNP	Ampl. pilota BF	V _{CEO} : 18 V	P : 145 mW	giallo	β	: 55 - 95		4	6
AC116			ACBO : 30 A	т _ј : 90°С	verde	β	: 85 - 140		4	6
	TO-1K		IC : 0,2 A	R _{thc} : 200 °C/W		hFE	65		20	1
						fβ	15 kHz		4	6
	PNP	Ampl. BF	V _{CEO} : 18 V	P : 0,26 W		hFE	: 120		50	6
AC117			VCBO 32 V	T _j : 90 °C		fβ	: 10 kHz		10	2
	TO - 1K		IC : 1 A	R _{thc} : 40 °C/W						
AC117P	PNP	Ampl. BF	Dati ternici come	AC117 eccetto:		her	: 60 - 400		150	2
	TO - 1K	compl. AC175P	Dati tecine, cons	- ACTIV eccetto.		HE	. 00 - 400		150	Z
	PNP	Ampl. BF	VCEO : 20 V	P : 0,15 W	(V	ptE	47		2	
		implego generale	VCBO : 20 V	Ta : 45 °C		bFE			2	
AC121			IC : 0,3 A	Tj : 90 °C		hFE			3	
				R _{thc} : 50 °C/W	VII	hFE			3	
							17 kHz		20	5
	TO - 1	<u></u>				fΤ	: 1,5 MHz		20	5
	PNP	Preampl. BF	VCEO : 18 V	P : 130 mW	rosso	β	: 40 - 65		2	6
			VCBQ : 30 V	T; : 90 °C	giallo	β	: 55 - 95		2	6
AC122			1C : 0,2 A		verde	β	: 85 - 140		2	6
AU ILL					viola	β	: 130 - 200		2	6
					bianco	Disp	: 170 - 300		2	6
	TO-18L					fβ	: 15 kHz		4	6
AC122/30	PNP		Impiego e dati te VCEO : 32 V	cnici came AC122 ecce	tto:					
	TO- 18L		VCBO : 45 V							
	PNP	Ampl. pilota BF	V _{CEO} : 32 V	P : 145 mW		hFE	: 65		20	1
		199000 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990	VCBO : 45 V	'T _i : 90 °C	giallo		: 55 - 95		4	6
AC123			lc : 0,2 A	R _{thc} : 200 °C/W	verde	β	: 85 - 140		4	6
	TQ - 1K					fβ	: 15 kHz		4	6
	PNP	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 32 V	P : 0,26 W		hee	: 62,5		50	6
AC124			VCBO : 45 V	Ti : 90 °C			: [10	2
	TO-1K		Ic : t A	Rthc: 40 °C/W		,				
***	PNP						*			
AC124P	TO - 1K		Impiego e dati te	cnici come AC124 ecce	tto:	hFE	: 60 - 170		150	2
	PNP	Preampi, e	V _{CEO} : 12 V	P : 0,5 W		hee	: 100		2	5
		pilota BF	V _{CBO} : 32 V	T _a : 45 °C			: 125		2	5
40405		p.1014 D.	IC : 0,1 A	aletta n. 1 e			: 1,7 MHz		10	2
AC125				diss. 12,5 cm ²			: 17 kHz		10	2
				T _j : 90 °C		-				
	TO-1			R _{tha} : 300 °C/W						
	PNP	Preampl, e	VCEO : 12 V	P : 0,5 W		hee	: 140		2	5
	1770	pilota BF	V _{CBO} : 32 V	T _a : 45 °C			: 180		2	5
		•	Ic : 0,1 A	aletta n. 1 e		- 5	: 2,3 MHz		10	2
AC126				diss. 12,5 cm ²			17 kHz		10	2
				Tj : 90 °C		W 5				
	TO-1			R _{tha} : 300 °C/W						

SIGLA	TIPO 6 CONT,	IMPIEGO	VALORI MASS (T _a = 25 °C		CARATTERISTICHE {T _a = 25 °C}	e I _C	V _{CI}
AC127	NPN	Pilota e finale BF compf. AC128 o AC132	VCEO : 12 V VCBO : 32 V IC : 0,5 A	P:0,34 W Ta:45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² Tj:90 °C Rtha:370 °C/W Rthc:110 °C/W	hFE: 100 1 _T : 2,5 MHz f _β : 20 kHz	20 10 10	2 2
AC128	PNP TO-1	Finale BF compl. AC127	VCEO : 16 V VCBO : 32 V IC : 1 A	P : 1 W aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² T _j : 90 °C Rtha : 290 °C/W Rthc : 40 °C/W	hFE : 100 f _T : 1,5 MHz fβ : 15 kHz	50 10 10	2 2
AC129	PNP C - 18	Preampt. BF basso rumore	VCEO : 6 V VCBO : 9 V IC : 10 mA	P : 12 mW T _a : 45 °C T _j : 60 °C	β : 40 - 135 f _β : 26 kHz	0,25	2
AC130	NPN TO-1	Stadi siner, orizz, TV	V _{CEO} : 10 V V _{CBO} : 20 V I _C : 0,1 A	P:145 mW T _j : 90 °C	hFE : >25 f _T : >2 MHz	10 10	1
AC131	PNP TQ - 18L	Ampl. finale BF	VCEO : 18 V VCBO : 30 V IC : 1 A	P:215 mW T;: 90 °C	hFE: 100 fβ: 10 kHz	50 10	2
AC131P	PNP TO-18L	Ampl, BF compl. AC186P	Dati tecnici come	AC131 eccetto:	hFE : 60 - 400	150	2
AC131/30	PNP TO-18L	Ampl. BF compl. AC186P	VCEO : 32 V VCBO : 45 V Ic : 1 A	P : 215 mW T _j : 90 °C	hFE:100 fβ:10 kHz	50 10	2
AC132	PNP	Finale BF compl. AC127	V _{CEQ} : 12 V V _{CBO} : 32 V I _C : 0,2 A	P: 0,5 W T _a : 45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² T _j : 90 °C Rtha: 300 °C/W Rthc: 50 °C/W	hpE : 135 fT : 2 MHz fg : 17 kHz	20 10 10	2 2
AC134	PNP TO-1	Ampl. pilota BF	VCEO : 18 V VCBO : 20 V IC : 35 mA	P:0,15 W	β : 35 fβ : 650 kHz f _T : 0,8 MHz	1	6
AC135	PNP TO-1	Ampt, finale BF	VCEO: 18 V VCBO: 20 V IC: 0,2 A	P:0,15 W	β : 65 f _T : 0,8 MHz	50	1
AC136	PNP TO-1	Ampt. finale BF	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 25 V I _C : 0,2 A	P : 0,15 W	β : 75 f _T : 0,8 MHz	50	1
AC137	PNP TO-1	Preampl, BF basso rumore	VCEO : 32 V IC : 35 mA	P : 0,15 W	β : 170 f _T : 0,8 MHz	5	1

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T _a = 25 °C)			TTERISTICHE (a = 25 °C)	a	Ic (mA)	V _{CE}
AC138	PNP	Ampl. pilota BF Commutazione	VCEO : 20 V VCBO : 25 V IC : 1,2 A	P: 0,72 W Ta: 45 °C aletta n. 1 con diss. alluminio 12,5 cm², spessore 1 Tj: 90 °C	,5 mm	β : 30 - 250 f_T : 1,2 MHz		5	6
AC139	PNP TO - 1	Ampl. finale BF Commutazione	Dati tecnici come VCBO : 32 V IC : 1 A	AC138 eccetto:		hFE: 40 - 110 f _T : 1,8 MHz		400	-
AC141	NPN TO-1	Ampl. finale BF Commutazione	Dati tecnici come V _{CBO} : 32 V	AC138 eccetto:		hFE: 40 - 110 f _T : 2,4 MHz		400	
AC141B	NPN TO-1		Impiego e dati teci	nici come AC138.					
AC141K	NPN TO-1K	Ampl. finale BF	VCBO : 32 V IC : 1,2 A	P : 0,86 W T _a : 45 °C con diss. alluminio 12,5 cm ² , spessore 1 T _i : 90 °C	,5 mm	hFE: 40 - 110 f _T : 2,4 MHz		400	
AC142	PNP TO-1		Impiego e dati teci VCBO : 32 V	nici come AC138 eccet	to:				
AC142K	PNP TO-1K		Impiego e dati tec	nici come AC141K ecc	etto:	f _T : 1,2 MHz			
AC150	PNP	Preampl. BF basso rumore	VCEO : 18 V VCBO : 30 V IC : 50 mA	P : 0,1 W T _j : 75 °C	giallo verde viola bianco	β : 55 - 95 β : 85 - 140 β : 130 - 200 β : 180 - 300 f _β : 15 kHz		2 2 2 2 2 4	6 6 6 6
AC151	PNP	Ampl. 8F uso generale	VCEO : 24 V VCBO : 32 V IC : 0,2 A	P : 0,15 W T _a : 45 °C T _i : 90 °C R _{thc} : 50 °C/W	IV V VI	β : 50 - 100 β : 75 - 150		2 2 2 3 2 1	1 1 1 1 0,5 5
AC151r	PNP TO-1	Ampl. BF uso generale		AC151 ma suddiviso so uadagno IV, V, VI.	olo			-	
AC152	PNP TO-1	Ampl. BF compl. AC127	VCEO : 24 V VCBO : 32 V IC : 0,5 A	P : 0,15 W Ta : 45 °C Tj : 90 °C Rthe : 50 °C/W	٧	hfE: 30 - 60 hfE: 50 - 100 hfE: 75 - 150 fβ: 15 kHz fT: 1,5 MHz		2 2 3 5 5	5 5
AC153	PNP	Ampl. BF compt. AC176	VCER: 32 V (RBE: ≤500 Ω VCBO: 32 V IC: 1 A	P : 1 W) T _C : 45 °C T _j : 90 °C R _{tha} : 300 °C/W R _{thc} : 40 °C/W		hFE: 66 hFE: 97 hFE: 167 fβ: 15 kHz fγ: 1,5 MHz.		50 50 50 10	2 2

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C		CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)	a	Ic (mA)	V _C i
	PNP	Ampl, BF	VCER : 32 V	P : 1W	V hFE: 66		50	
		compl. AC176K	(R _{BE} : ≤500 Ω)		VI hFE: 97		50	
AC153K			VCBO: 32 V	Tj : 90 °C	VII heE: 167		50	
	TO 414		Ic : 1 A	Rthc : 45 °C/W	fβ : 15 kHz		10	2
	TO-1K				f _T : 1,5 MHz		10	2
	PNP	Preampl. BF	VCEO : 10 V	P : 50 mW	rosso β : 35- 65		0,3	4,5
		basso rumore	VCBO : 15 V	T _i : 75 °C	giallo β 55-100		0,3	4,5
AC160			IÇ : 10 mA	,	verde β : 80 - 150		0,3	4,5
					viola β : 120 - 250		0,3	4,5
	TO - 18i		K.		f _T : 2 MHz		0,3	4,6
	PNP	Ampl. BF	V _{CEO} : 24 V	P : 0,15 W				
		Ampi. Di	VCBO : 32 V	Ta : 45 °C	hFE: 93		2	5
AC162			IC : 0,2 A	T _j : 90 °C	β : 80 - 170 f _β : 17 kHz		2	5
	TO - 1			R _{thc} : 50 °C/W	ή : 1,7 MHz		10 10	2
							_	
	PNP	Ampl. BF	VCEO : 24 V	P : 0,15 W	hFE : 125		2	5
AC163			VCBO : 32 V	T _a : 45 °C	β : 130 - 300		2	5
	TO-1		IC : 0,2 A	T _j : 90 °C	fβ : 17 kHz	0	10	2
				R _{thc} : 50 °C/W	f _T : 2,3 MH₂		10	2
	PNP	Preampl. e	V _{CEO} : 15 V	P : 90 mW	hFE : 125		2	5
AC170		pilota BF	VCBO : 32 V	Ta: 45 °C	β : 80 - 170		2	6
	TO 40.		IC : 0,2 A	Τ _j : 90 °C	fβ : 17 kHz		10	2
	TO-18L				fT : 1,7 MHz		10	2
	PNP	Preampl, e	VCEO : 15 V	P : 90 mW	hpg : 180		2	5
AC171		pilota BF	VCBO: 32 V	Ta: 45 °C	β : 130 - 300		2	6
40171			IC : 0,2 A	Tj : 90 °C	f _B : 17 kHz		10	2
	TO - 18L				f _T ; 2,3 MHz		10	2
	NPN	Preampl. BF	V _{CEO} : 32 V	P : 0,2 W	β: 45-110	0. 0. 0.	1	5
AC172		basso rumore	V _{CBO} : 32 √	Tj : 90 °C	f _T : 2,5 MHz		10	2
	TO-1		IC : 10 mA		in the second			
	NPN	Ampl. finale BF	VCEO : 18 V	P : 0,26 W	hFE : 165		50	6
LC175	157 15	rangi. Imale bi	VCBO : 25 V	T _i : 90 °C	fβ : 20 kHz		10	2
	TO-1K		IC : 1 A	R _{thc} : 40 °C/W	·β . 20 KH2		10	2
			* ,	-928 39				
AC175P	NPN TO 14	Ampi. BF	Dati tecnici come A	AC175 eccetto:	hee: 100 -400		150	2
	TO-1K	compl. AC117P						VALUE .
	NPN	Ampl. 8F	VCEO : 18 V	P : 1 W	hFE : 35		50	
C176		compl. AC153	VCBO: 32 V	T _C : 45 °C	fg : 15 kHz		10	2
10170			IC : 1 A	Tj : 90 °C	f _T : 3 MHz		10	2
	TQ - 1			Rthc: 40 °C/W				
	NPN	Ampl. BF	VCEO : 18 V	P : 1W	hFE: 35		50	2
CATES		compl. AC153K	VCBO : 32 V	T _C : 45 °C	f ₇ : 3 MHz		10	2
AC176K		10000 00	IC : 1 A	Tj : 90 °C	¶ =			
	TO-1K			R _{thc} : 45 °C/W			9	
	PNP	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 15 V	P : 0,18 W	hFE : 185		50	2
0176		compl. AC179	VCBO : 20 V	Ta : 45 °C	fβ : 10 kHz		10	2
C178			IC : 0,7 A	T _i : 90 °C				
	TO-1K		12 22	Rthc: 40 °C/W				

IGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)	a Ic (mA)	V _C I (V
AC 178P	PNP TO - 1K		Impiego e dati tecnici come AC178 ecco	etto: hFE : 100 - 400	150	2
200	NPN	Ampl, finale BF compl. AC178	V _{CEO} : 15 V P : 0,18 W V _{CBO} : 20 V T _a : 45 °C	hpe : 185 fg : 20 kHz	50 10	2 2
C179	TO - 1K		IC : 0,7 A T _j : 90 °C R _{thc} : 40 °C/W	μ	100	
AC179P	NPN TO-1K		Impiego e dati tecnici come AC179 eccet	tta: hFE : 100 - 400	150	2
•	PNP	Ampl, finale BF	VCEO : 16 V P : 0,3 W	V hFE: 50 - 100	600	1
		compi. AC181	VC8O : 32 V T _j : 100 °C	VI hFE: 75-150	600	1
AC 180			IC : 1,5 A Rthc : 30 °C/W	VII hFE: 125 - 250	600	1
				f _T : 2,5 MHz	1	6
	TO-1			fβ : 20 kHz	1	6
AC160K	PNP TO - 1 K	Ampt, finale 8F compl, AC181K	Dati tecnici come AC180 eccetto: P : 0,44 W			
				blu hpg : 70	10	1
AC180D			Equivalente atl'AC180, ma selezionato	viola hFE: 90	10	1
10.000			per l'impiego negli stadi pilota di BF	bianco hpp: 125 grigio hpp: 195	10 10	1
	NPN	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 16 V P : 0,3 W	V hFE: 50-100	600	1
	0.00	compl. AC180	VC8O: 32 V Tj : 100 °C	VI hFE: 75-150	600	1
AC181			IC : 1 A Rthe : 30 °C/W	VII hFE: 125-250	600	1
				t _T : 4,5 MHz	1	6
	TO-1		Street St.	fβ : 35 kHz	1	6
AC181K	NPN TO-1K	Ampl. finale BF compl. AC180K	Dati tecnici come AC181 eccetto: P : 0,44 W			
				blu hpE: 70	10	1
AC181d			Equivalente all'AC181, ma selezionato	viola hFE: 90	10	1
AC 10 10			per l'impiago negli stadi pilota di BF	bianco hpg: 125 grigio hpg: 195	10 10	1
		Ver 1990			2	6
	NPN	Preampl. e	VCEO: 16 V P : 0,25 W	$V \beta : 75$ $V \beta : 110$	2	6
5 D 1 D 2		pilota BF	VCBO : 32 V Tj : 100 °C	VI β : 110	2	6
AC183			IC : 0,15 A Rthc : 100 °C/W	f _T : 4,5 MHz	1	6
	10-1			f _β : 35 kHz	i	6
	PNP	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 16 V P : 0,27 W	V hpg: 50-100	300	ı
		compl. AC185	V _{CBO} : 32 V T _j : 100 °C	VI hpg : 75 - 160	300	1
AC184			IC : 0,5 A Rthc : 60 °C/W	VII hFE: 125 - 260	300	Ţ
	TO-1			f _T : 2,5 MHz fβ : 20 kHz	1	6 6
				blu heg : 70	10	1
			Equivalente all'AC184, ma selezionato	viola hFE: 90	10	1
AC184D			per l'impiego negli stadi pilota di BF	bianco hpg : 125	10	14
			her verthinks india amor burying at mi	E	10	1

IGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C)			TERISTICHE = 25 °C)	a I _C (mA)	V _{CE}
AC185	NPN	Ampl. finale BF compl. AC184	VCEO : 16 V VCBO : 32 V IC : 0,5 A	P : 0,27 W T _j : 100 °C R _{thc} : 60 °C/W	VII VI	hFE: 50 - 100 hFE: 75 - 150 hFE: 125 - 250 f _T : 4,5 MHz	300 300 300 1	1 1 1 6
	TO - 1					fβ : 35 kHz	1	6
- 107					blu	hFE: 70	10	1
C185D				185, ma selezionato li stadi pilota di BF	bianco	hfe : 90 hfe : 25 hfe : 195	10 10 10	1 1 1
C186	NPN	Ampl. pilota e finale BF	V _{CBO} : 18 V V _{CBO} : 30 V	P : 0,215 W T _j : 90 °C		hFE: 100 fβ: 20 kHz	50 10	2
	TO - 18L		I _C : 0,7 A					
AC186P	NPN TO - 18L	Ampl. finale BF compl. AC131P	Dați tecnici come	AC186 eccetto:		hFE : 100 - 400	150	2
AC187	NPN	Ampl, finale BF compl. AC188	V _{CEO} : 15 V V _{CBO} : 25 V 1 _C : 1 A	P : 0,56 W T _a : 45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² T _j : 90 °C		hFE: 300 fT: 3 MHz fβ: 20 kHz	300 10 10	
	TO - 1		7005 	R _{thc} : 40 °C/W				
AC187K	NPN	Ampl. finale BF compl. AC188K	VCEO : 15 V VCBO : 25 V IC : 1 A	P : 0,64 W Ta : 46 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² Ti : 90 °C Rthc : 45 °C/W		hpe: 91 - 455 fg : 5 MHz fβ : 20 kHz	50 10 10	
AC 188	PNP TO - 1	Ampl. finale BF compl. AC187	Dati tecnici come		· <u>-</u>	f _T : 1,5 MHz f _β : 10 kHz	10 10	
AC188K	PNP TO-1K	Ampl. finale BF compl. AC187K	Dati tecnici come	AC187K eccetto:		f _T : 1,5 MHz fβ : 10 kHz	10	
AC191	PNP TO - 1	Ampl. BF basso rumore Commutazione	V _{CBO} : 32 V I _C : 0,25 A	P:0,43 W T _j : 90 °C		β : 30 - 500 f _T : 5,5 MHz	1	6
AC192	PNP TO - 1	Pilota BF Commutazione	V _{CBO} : 32 V I _C : 0,25 A	P:0,43 W Tj: 90 °C		β : 30 - 500 f _T : 5,5 MHz	1	6
AC193	PNP	Pilota BF Commutazione	V _{CBO} : 32 V I _C : 1 A	P: 0,72 W aletta n. 1 con diss. alluminio 12,6 cm ² , spessore T ₁ : 90 °C	1,5 mm	hFE: 90 - 400 f _T : 3 MHz	400	r.
AC193K	PNP TO-1K		Impiego e dati te	enici come AC193 ecce P : 0,86 W	etto:	9		
AD130	PNP	Ampt. finale BF di potenza Circuiti alim.	VCEO : 30 V VCBO : 32 V IC : 3 A	P : 30 W Tc : 45 °C Tj : 90 °C Rthc : 1,5 °C/W	III IV V	hfE: 49 hFE: 74 hFE: 124 fβ: 10 kHz fT: 0,35 MHz	50 50 60 600))) 2

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C			TTERISTICHE Ta = 25 °C)	ą	lc (mA)	V C
	PNP	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 45 V	P : 30 W	ш	hFE : 49		50	
		di potenza	VC80 : 64 V	T _C : 45 °C		hFE : 74		50	
AD131		Circuiti alim.	IC : 3 A	T _i : 90 °C	V			50	
				R _{the} 1,5 °C/W		f _T : 0,35 MHz		500	2
	TO - 3					fβ : 10 kHz		500	2
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 60 V	P : 30 W	811	hFE: 49		50	
		di potenza	VCBO : 80 V	T _C : 45 °C	ťV	hFE: 74		50	
AD 132		Circuiti alim.	IC : 3 A	T _j : 90 °C	V	hFE: 124		50	
	TO-3			R _{thc} : 1,5 °C/W		f_T : 0,35 MHz f_{β} : 10 kHz		500 500	2 2
	PNP	Ampl, finale BF	VCEO : 32 V	P : 36 W		hFE : 50		500	
		di potenza	V _{CBO} : 50 V	T _C : 45 °C		hfe: 75		500	
AD 133		Circuiti alim.	IC : 15 A	Tj : 100 °C	٧	hFE : 125		500	_
	TO-41			R _{thc} : 1,5 °C/W		$f_{\mathbf{T}}$: 0,3 MHz $f_{\boldsymbol{\beta}}$: 8 kHz		500 500	6 6
	PNP	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 22 V	P : 11 W	iV	hee: 75		500	
		di potenza	VCBO : 40 V	T _C : 45 °C	V			500	
AD136		Circuiti alim,	IC : 10 A	Tj : 100 °C		hFE : 180		500	
		c		Rthc: 5 °C/W		f _T : 0,3 MHz		500	6
	TO-8					fβ 8 kHz		500	6
**************************************	PNP	Ampt, finale BF	VCEO : 25 V	P : 30 W		hFE : 62,5		500	1,5
			VCBO: 40 V	T _C : 45 °C		fβ : 5,5 kHz		500	6
AD138			IC : 8 A	Tj : 90 °C		<i>E</i>			
	TO-3		37	R _{thc} : 1,5 °C/W		2 2			9 000
	PNP		Impiego e dati te	onici come AD138 eccet	to:				
AD138/50			V _{CEO} : 35 V						
	TO-3		V _{CBQ} : 70 V						
	PNP	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 20 V	P : 13 W		hFE: >20		10	10
AD139			V _{CBO} : 32 V	T _C : 38 °C		f _T : 0,6 MHz		100	2
4D 133			IC : 3,5 A	Tj : 90 °C		fβ : 10 kHz		100	2
	SOT-9			R _{thc} : 4 °C/W					-,
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 50 V	P : 30 W		hFE: 50 - 175	29	1000	2
AD142	20	Commutazione	VCBO : 80 V	T _C : 55 °C					
10172	TO-3		IC : 10 A	Tj : 100 °C R _{thc} : 1,5 °C/W					
	PNP		Impiego e dati ter	onici come AD142 eccet	to:				
AD143			VCEO : 30 V						
	TO - 3		VCBO : 60 V						
	PNP		12001 CONT 10 100 100 CONT. CONT.	nici come AD143 eccett	o:				
AD143R	TO-3		V _{CEO} : 25-V V _{CBO} : 32 V						
		•) #:!- PC	Vore : 26 V	P : 13.5 W		hee : 51		50	
	PNP	Ampl, finale BF	VCEQ : 26 V		V	hfg: 51		50 50	
AD 148			VCBO; 32 V IC :3,5 A	T _C : 45 °C T _i : 100 °C	v	hpe: 85 f _T : 0,45 MHz		500	2
	COT 0		1C : 3,5 A	R _{thc} : 4 °C/W		f _B : 12 kHz		500	2
	SOT-9			TINE . 4 CAN		p ie kiiż			-

IGLA	TIPO	IMPIEGO	VALORI MAS				RISTICHE	a (-	Vo
	CONT.		(T _a ≃ 25 °C			= 2	5 °C}	(m	A)	(\
	PNP	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 30 V	P : 27,5 W	IV	hFE	: 50	5	0	1
D140			VCBQ : 50 V	T _C : 45 °C	V	hFE	: 82	5	0	3
D149			IC : 3,5 A	T _i : 100 °C		fT	: 0,5 MHz	50	0	2
(-	TO-3		2378	R _{thc} : 2 °C/W		fβ	: TO kHz	50	0	2
	PNP	Ampl, finale BF	VCEO : 30 V	P : 27,5 W	IV	hFE	: 50	5	0	1
D150			V _{CBO} : 32 V	T _C : 45 °C			: 82	5		1
			IC : 3,5 A	т _ј : 100 °С			: 0,45 MHz	50		2
	TO - 3			R _{thc} : 2 °C/W		' β	: 12 kHz	50	0	2
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 23 V	P : 6W		hFE		5		6
D 152			V BO : 45 V	T _C : 45 °C		fβ	: 11 MHz	1	0	2
	SOT-9		Ic : 1 A	Tj : 90 °C R _{the} : 7,5 °C/W						
	301-9	 		ntac . 7,5 GA	•					
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 15 V	P 🛊 : 6 W			: 126	5		6
LD 155			VCBO : 25 V	T _C : 45 °C		fβ	: 11 kHz	1	0	2
ID 199		Ē.	Ic : 1 A	T _j : 90 °C						
	SQT-9			R _{thc} : 7,5 °C/W						
D155P	PNP		Impiego e dati te	cnici come AD155 eccetto):	hFE	: 65 - 320	50	0	1
	SOT - 9									
	PNP	Commutazione e	VCEO : 18 V	P : 9W		hFE	: 83	50	0	0,5
D160		circuiti alim.	VC80 : 40 V	T _C : 45 °C		fΨ	: 0,3 MHz	50		6
D159			IC : 8 A	Tj : 90 °C		fß	: BkHz	50	Ю	6
	TO -8			R _{thc} : 5 °C/W		_				
	PNP	Commutazione e	V _{CEO} : 22 V	P : 9 W			: 155	50	ю	0,5
		circuiti alim.	VCBO : 40 V	T _C : 45 °C		fT	: 0,3 MHz	50		6
D 160			IC : 10 A	Tj : 90 °C		fβ	: BkHz	50	Ю	6
	TO - 8			Rthe: 5 °C/W						
	NPN	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 20 V	P : 4W		hFE	: 80 - 320	50	ю	1
		compl. AD162	VCBO: 32 V	Tc : 72 °C		fT	: 3 MH2	1	0	2
AD 161			Ic : 1 A	Tj : 90 ℃		fβ	: 35 kHz	30	0	2
	SOT-9			R _{thc} : 4,5 °C/W						
	PNP	Ampl. finate BF	VCEO : 20 V	P : 6W			: 67		ю.	
		compl. AD161	VCBO : 32 V	T _C : 63 °C			: 98		0	
D102			IC : 1 A	T _i : 90 °C			: 170		0	
D162				Rthc: 4,5 °C/W	VIII		: 235		0	
							: 1,5 MHz	30		2
	SOT - 9					fβ	: 15 kHz			2
	PNP	Ampl. finale BF e	VCEO: 80 V	P : 30 W	11		: 30		0	
		circuiti alim.	VCBO: 100 V	T _C : 45 °C			: 49		0	
AD163			1 _C : 3 A	τ _j : 90 °C	IV		: 74		0	2
	TO-3			R _{thc} : 1,5 °C/W			: 0,35 MHz : 10 kHz	50 50		2
			DIES CONT. NO.					•••		
	PNP	Ampl, finale BF e	V _{CEQ} : 20 V	P:6W			: 120		0	6
AD164		circuiti alim.	V _{CBO} : 25 V	T _C : 45 °C		fβ	: 11 kHz	1	Q	2
4D 104			IC : 1 A	Tj : 90 °C						
	SOT -9			Rthc : 7,5 °C/W						

SIGLA	TIPO 8 CONT.	IMPIEGO	VALOR! MASS (Ta = 25 °C)	SIMI (CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)			f (MHz)
AD184P	PNP SOT - 9		Impiego e dati tecr	nici come AD164 eccetto:	hFE : 80 - 145	500	1	
	NPN	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 20 V	P : 6,3 W	hFE : 180	50	6	
AD165			V _{CBO} : 25 V	T _C : 45 °C T _j ': 90 °C	fβ : 20 kHz	10	2	
	SOT-9		lc : 1 A	R _{the} : 8,5 °C/W				
AD165P	NPN SOT-9	ē	Impiego e dati tec	nici come AD165 eccetto:	hFE: 80 - 345	500	1	
	PNP	Ampl. finale BF	V _{CEQ} : 26 V	P : 6W	hFE : 83	50	6	
AD 169			VCBO : 45 V	T _C : 45 °C	fβ : t1 kHz	10	2	
	SOT - 9		I _C : 1 A	T _j : 90 °C R _{thc} : 7,5 °C/W				
AD169P	PNP SOT - 9		Impiego e dati tec	nici come AD169 eccetto	hFE : 40 - 160	500	1	
	PNP	Ampl. oscill, VHF	V _{CEO} : 25 V	P : 75 mW	β :>20	1	12	
AF 102			VCBO : 25 V	Ta: 45 °C	f _T : 180 MHz	1	12	
	TO - 7		1C : 10 mA	т _j : 75 °С	γ _{fb} : 25 mS		12	200
	PNP	Ampl. RF-FI	VCER : 12 V	P : 30 mW	hFE : 50	1	12	
AF105		per OM - OC	$(R_{BE}: 30 k\Omega)$	Ta: 45 °C	β:60	95	6	
H. 100	RO-87		V _{C80} : 25 V	T _j : 75 °C	y _{fe} : 19 mS f _T : 22 MHz	0,5 0,5	6 6	
	PNP	Preampl, RF	V _{CEO} : 18 V	P:60 mW	hpE: 70	2	6	
		oscill. conv. VHF	V _{CBO} : 25 V	Ta: 45 °C	β : 65	1	12	25
AF106	TO - 72		IC : 10 mA	Tį:90 °C	y _{fe} : 36 mS f _T : 220 MHz	1	†2 †2	35
AF106A	PNP TO - 72		Impiego e dati tec	nici come AF106 eccetto	hFE : 20	1	12	
	PNP	Ampl, RF	V _{CEO} : 15 V	P : 60 mW	hFE : 55	2	6	
AF109R	TO - 72	fino a 260 MHz	VĆBO: 20 V IC: 10 mA	T _a : 45 °C T _i : 90 °C	γ _{fb} : 22 mS f _T : 260 MHz	1,5	12	200
	PNP		Impiego e dati tec	nici come AF124 eccetto	:	_		
AF114	TO-7			P : 50 mW T _a : 45 °C				
AF115	PNP		Impiego e dati tec	nici come AF125 eccetto P : 50 mW				
AF110	TO-7	2		Ta: 45 °C				
A E 110	PNP		Impiego e dati tec	nici come AF126 eccetto P : 50 mW	:			
AF116	TO-7			T _a : 45 °C				
AF117	PNP TO-7	4	Impiego e dati teci	nici come AF127				
	PNP	Ampl. finale	VCEO : 70 V	P : 0,4 W	hFE : 180	10	2	10.7
AF118		video TV	VCBO: 70 V IC: 30 mA	aletta n. 4 Tj.: 75 °C	γ _{fe} : 130 mS f _T : 175 MHz	10 10	6 6	10,7
	TO - 7		, 30 mA	R _{the} : 250 °C/W			~	

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS	iMI	CARATTERISTICHE a		V _{CE} (V)	f (MHz
	PNP	Ampl. RF	V _{CEO} : 25 V	P : 65 mW	h p e : 75	3	10	
AF121		oscill, AM-FM	VC80 : 25 V	Ta : 45 °C	yfe : B0 mS	3	10	35
47 12 1		fino a 100 MHz	IC : 10 mA	Tj : 75 °C	G _{tr} : 19 dB	2	5	100
	TO - 72LR			R _{thc} : 220 °C/W	f _T : 270 MHz	3	10	
	PNP	Ampl. RF-FM	VCEO : 15 V	P : 40 mW	hFE: 140	1	6	
		fino a 100 MHz	VCBO : 32 V	Ta : 45 °C	β : 150	1	6	
F124			IC : 10 mA	T _i : 75 °C	yfb : 150 mS	1	6	100
				Rthc: 400 °C/W	G _p : 14 dB	1	6 6	100
	TO - 72R				f _T : 75 MHz		. D	
	PNP	Ampl. RF - FI	V _{CEO} : 15 V	P : 40 mW	hFE : 140	,	6	
	rnr	oscill, fino a	VCBO : 32 V	Ta : 45 °C	β : 150	1	6	
AF 125		27 MHz	IC : 10 mA	Ti : 75 °C	Yfp : 34 mS	1	6	10,7
			•	R _{thc} : 400 °C/W	G _p : 13 dB	1	6	100
	TO - 72R				f _T : 75 MHz	1	6	400
	PNP	Ampl. RF-FI	V _{CEO} : 15 V	P : 40 mW	hFE : 140	1	6	
	ring	tino a 16 MHz	VCBO : 32 V	Ta 45 °C	β : 150	1	6	
AF126		1110 2 12 11111	IC : 10 mA	Tj : 75 ℃	y _{fe} : 32 mS	1	6	10,7
				R _{thc} : 400 °C/W	Gp : 25 dB	1	6	10,7
	TO - 72 R				1 _T : 75 MHz	1	6	
14 mars 14 mars	PNP	Ampl. RF-FI	VCEO : 15 V	P : 40 mW	hpg : 140	1	6	
	1141	fino a 6 MHz	VCBO : 32 V	Ta : 45 °C	β : 150	1	6	
AF127			IC : 10 mA	Tj : 75 °C	γ _{te.} : 37 mS	1	6	0,4
			100	R _{thc} : 400 °C/W	G _p ∶ 42 dB	,		0.48
	TO - 72R				1 _T : 75 MHz		6	
	PNP	Ampl. RF	VCEO: 6 V	P : 12 mW	β : 25 - 135			
AF128		per OM-OC	VCBO: 9 V	Ta : 45 °C	f _T 6 MHz	0,25	10	
	C-18		IC : 10 mA	τ _j : 60 °C				
	PNP	Ampl. RF per VHF	VCER : 18 V	P : 60 mW	β : 110	1	6	
AF134	1.134	Cimpt. III par 1111	(RBE : 30 kΩ)	Ta : 45 °C	y _{fb} : 22 mS	1	6	100
	TO - 72L		V _{CBO} : 25 V	Tj : 75 °C	f ⊤ : 55 MHz	1	6 	
=	PNP	Ampl. RF per VHF	V _{CER} : 18 V	P : 60 mW	β : 100	1	6	
AF135	FNF	Ampr. vii per vivi	(R _{BE} : 30 kΩ)		ν _{fb} : 21 mS	1	6	10
	TO - 72L		VCBO : 25 V	Tj : 75 °C	f† : 50 MHz	1	6	
		A serior	V _{CER} : 18 V	P : 60 mW	β : 80	1	6	
AF 136	PNP	Ampl. RF oscill. conv.	(RBE : 30 kΩ)		Yfe : 36 mS	1	6	2
A1 130	TO - 72L		VCBO : 25 V	τ _j : 75 °C	fγ : 40 MHz	1	6	
*	PNP	Ampl. RF-FI	V _{CER} : 18 V	P : 60 mW	β : 60	1		
AF137	FINE	per MA-MF	(ABE : 30 kΩ)	Ta : 45 °C	Yfe: 36 mS	1	6 6	10,
	TO - 72L	•	VCBO : 25 V	Tj : 75 °C	t _T : 35 MHz	1		
Walter Street	PNP	Ampl. FI	Dati tecnici com	e AF137 eccetto:	β ; 100	1	6	
AF138		per MA-MF		A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	f _T : 40 MHz	1	6	
			V _{CEO} : 15 V	P : 60 mW	hFE : 56	2		
	PNP	Ampl. RF oscill. conv. UHF	VCBO : 20 V	T _a : 45 °C	Vin 1 14 mS	1		. 80
AF139		fino a 860 MHz	IC : 10 mA	т _ј : 90 °С	Guil : 11,5 au	1,5		80
	TO - 72		15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1		1 100 MH	z 1,5	12	

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE a (T _a = 25 °C)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	f {MHz
AF142	PNP TO-7	Ampl. RF per MF	VCBO : 30 V P : 80 mW IC : 10 mA T _j : 90 °C	β : 190 У _{fb} : 18 mS f _T : 150 MHz	1,5 1	6 9	100
AF143	PNP TO-7	Oscill, conv. per MF	VCBO : 30 V P : 80 mW IC : 10 mA T _j : 90 °C	β : 85 γ _{fb} : 15 mS f _T :130 MHz	1,5	6 9	100
AF144	PNP	Ampl. FI per MA-MF	VCBO : 30 V P : 80 mW IC : 10 mA T _j : 90 °C	β : 65 y _{fe} : 37 mS G _{UM} : 25 dB f _T : 130 MHz	1,5 1 1,5 1,5	6 6 6 6	10,7 10,7
AF146	PNP TO-7	Oscill. conv. per OM-OC	VCBO : 30 V P : 80 mW 1C : 10 mA Tj : 90 °C	β:100	1	6	
AF147	PNP TO - 7	Ampt. RF per MA	V _{CBO} : 24 V P : 80 mW IC : 10 mA T _j : 90 °C	β:80	1	6	
AF148	PNP TO - 7	Oscitl. conv. per OM-OC	V _{CBO} : 24 V P : 80 mW I _C : 10 mA T _j : 90 °C	β:100	1	6	
AF149	PNP TO - 7	Ampl. Fl per MA	Dati tecnici come AF171				
AF150	PNP TO - 7	Ampl, Fiper MA	VCBO : 24 V P : 80 mW IC : 10 mA T _j : 90 °C	β : 70 Y _{fe} : 37 mS G _{UM} : 34,5 dB	1 1 1	6 9 6	0,45 0,45
AF164	PNP TO - 44		Impiega e dati tecnici come AF142			ē	
AF 165	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF143				
AF166	PNP TO - 44		Impiago e dati tecnici come AF144				
AF168	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF146				
AF169	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF147				
AF170	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF148				
AF171	PNP TO - 44	Ampl. Fl per MA	V _{CBQ} : 24 V P : 80 mW I _C : 10 mA T _j : 75 °C	β : 225 G _{UM} : 34,5 dB	1	6	0,45
AF172	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF150				

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T ₈ = 25 °C)		CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)		V _{CE} (V)	f (MHz
AF178	PNP	Ampl. RF oscill. conv. VHF	VCBO : 25 V IC : 10 mA	P : 50 mW T _a : 45 °C T _i : 75 °C	hFE:>20 β:>20 V _{fb} : 25 mS	1 1 1	12 12 12	200
	TO-12			,	f _T : 180 MHz	1	12	
AF179	PNP TO-12	Ampl. FI video TV	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 25 V I _C : 10 mA	P : 95 mW T _j : 80 °C R _{thc} : 170 °C/W	Yfe : 80 mS f _T : 270 MHz	3	10 10	35
AF180	PNP TO-12	Ampl. RF per VHF	VCEO : 25 V VCSO : 25 V IC : 20 mA	P : 0,156 mW T _j : 75 °C	ν _{fe} : 35 mS G _p : 14 dB	3,5 3,5	10 10	200 200
AF181	PNP	Ampl. F1 video TV	V _{CER} : 30 V V _{CBO} : 30 V	P : 0,156 mW T _j : 75 °C	h∉∈: 60 Yfe : 85 mS	3	10 10	35
	TO - 12	Stadio controllato	I _C : 20 mA	R _{thc} : 140 °C/W	f _T : 170 MHz	3	10	
AF186	PNP	Preampl, RF (punto nero) e conv. oscill.	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 25 V I _C : 15 mA	P : 46 mW T _a : 45 °C T _i : 75 °C	G _p : 9 dB f _T : 820 MHz nero v _{fb} : 18 mS	2 2 2	10 10 10	860 900
	TQ -721.		, 13 mA	1,	rosso y _{fb} : 22 mS	2	10	900
AF200	PNP	Ampl. FI video TV	V _{CES} : 25 V V _{CBO} : 25 V	P : 0,1 W T _a : 45 °C.	h _{FE} : > 30 β : 150	3	10 10	
	TQ-72LF	t	1C : 10 mA	†j : 90 °C R _{thc} : 200 °C/W	V _{fe} : 92 mS	3	10	35
AF201	PNP TQ - 72Lf	A	Impiego e dati teo	nici come AF200 eccet	hpe:>20 Yee:95 mS	3 3	10 10	35
AF202	PNP TQ - 72 LF	3	Impiego e dati teo	nici come AF200 eccet	tto: hFE:>20 v _{fe} :95 mS	3 3	10 10	35
AF202S	PNP	Ampl. FI video TV	VCES : 32 V VCBO : 32 V IC : 30 mA	P : 0,1 W T _a : 45 °C T _i : 90 °C	hee:>20 β ::150 γ _{te} ::95 mS	3 3 3	10 10 10	35
	TO-72LF	3	10 1.30 MK	R _{thc} : 200 °C/W	716			
AF239	PNP	Ampl. RF oscill. conv. UHF	V _{CEO} : 15 V V _{CBO} : 20 V	P : 60 mW T _a : 45 °C	hFE : 33 Vfb : 20 mS	2 2 2	10 10 10	800 800
	TO - 72	fino a 890 MHz	IC : 10 mA	7j:90 ℃	G _{UM} : 17 d8 f _T : 650 MH:		10	
AF239\$	PNP TO-72		Impiego e dati ted	nici come AF239 eccet	to: G _{tr} : 15 dB f _T : 780 MHz	2 2	10 10	800
AF240	PNP	Ampl. RF oscill. VHF-UHF	V _{CEO} : 15 V V _{CBO} : 20 V	P : 60 mW T _a : 45 °C	h _{FE} : 25 G _{tr} : 14 dB	2	10 10	800
	TO-72		IC : 10 mA	T _j : 90 °C	f _T : 650 MHz		10	
AF251	PNP MM - 12	Ampl. RF per UHF	V _{CEO} : 15 V V _{CBO} : 20 V I _C : 10 mA	P : 90 mW T _a : 45 °C T _j : 90 °C	hee: 30 f _T :750 MHz	2	12 12	

SIGLA	TIPO 8 CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (T _a = 25 °C)	SIMI	CARATTERISTICHE a (T _a = 25 °C)		V _{CE}	f {MHz
AF262	PNP MM - 12 A	Oscill, conv. UHF	VCEO : 15 V VCBO : 20 V IC : 10 mA	P : 90 mW T _a : 45 °C T _i : 90 °C	hFE:>10 f7:650 MHz	2	12 12	
AF253	PNP MM-12A	Ampl. RF per UHF	VCEQ : 15 V VCBQ : 20 V IC : 10 mA	P : 90 mW T _a : 45 °C T _i : 90 °C	hFE: > 10 f _T : 550 MHz	2	12 12	
AF256	PNP MM - 12A	Ampl. RF oscill. VHF	V _{CEO} : 18 V V _{CBO} : 25 V I _C : 10 mA	P : 90 mW T _a : 45 °C T _i : 90 °C	hFE : 28 f _T : > 170 MHz Yfb : 14 mS	1 1 1,5	12 12	
AF279	PNP TO - 50	Ampl. RF oscill, UHF	VCEO : 15 V VCBO : 20 V IC : 10 mA	P : 60 mW Ta : 55 °C Tj : 90 °C	hFE: 50 f _T : 780 MHz	2	10 10	
AF280	PNP TO - 50	Ampl. RF oscill, UHF	VCEO : 15 V VCBO : 20 V IC : 10 mA	P : 60 mW T _a : 55 °C T _j : 90 °C	hFE : 25 f _T : 550 MHz G _{tr} : 12 dB	2 2 2	10 10 10	800
AFY12	PNP TO - 72	Ampl. RF oscill. VHF	V _{CBO} : 12 V I _C : 10 mA	P : 112 mW T _C : 45 °C T _i : 90 °C	hpg: 25 - 120 fT : 230 MHz	1	12	
AFY16	PNP TO - 72	Ampl. RF per UHF	V _{CBO} : 30 V I _C : 10 mA	P : 112 mW T _C : 45 °C T _j : 90 °C	hFE : > 10 fT : 550 MHz	1,5	12	
AL 100	PNP TO-3	Commutazione alta velocità	VCEO : 40 V VCBO : 100 V IC : 10 A	P : 50 W T _C : 25 °C T _j :100 °C	bFE: 40-250 1 _T : 7,5 MHz	1000 1000	1	
AL101	PNP TO-3	Commutazione alta velocità	VCEO : 40 V VCBO : 60 V IC : 10 A	P : 50 W T _C : 25 °C T _j :100 °C	hFE: 40-250 f _T : 7,5 MHz	1000 1000	1	
AL 102	PNP TO - 3	Ampl, finale BF Commutazione	VCEO : 50 V VCBO : 75 V IC : 5 A	P: 12,5 W T _C : 81 °C T _j : 100 °C	hFE: 40-250 β: 150 1 _T : 4 MHz	1000	1	
AL103	PNP TO-3	Ampl. finale BF Commutazione	VCEO : 40 V VCBO : 60 V	P : 12,5 W T _C : 81 °C T _i : 100 °C	h _{FE} : 40 - 250 β : 80 f _T : 3 MHz	1000 1000	1	
AL112	PNP SOT-9	Ampl. di potenza Commutazione	V _{CEO} : 60 V V _{CBO} : 130 V I _C : 6 A	P : 10 W T _C : 60 °C T _j : 100 °C	hFE: 30 - 180 fT: 3 MHz	500	2	
AL113	PNP SOT-B	Ampl. di potenza Commutazione	VCEO : 40 V VCBO : 100 V IC : 6 A	P: 10 W Tc: 60 °C Tj: 100 °C	h⊭€ : 40 - 180 fT : 3 MHz	500	2	
ASY26	PNP	Commutazione	VCEO : 15 V VCBO : 30 V IC : 0,2 A	P : 0,15 W T _j : 85 °C R _{the} : 200 °C/W	hpe:>30 fT : 8 MHz t _{on} : 340 ms t _{off} : 975 ms	20 3	1 5	

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS {T _a = 25 °C		CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)	a I _C (mA)	V c (V)
	PNP .		Impiego e dati teo VCBO : 25 V	пісі come ASY26 eccetto		20	1
\\$Y27	TO - 5		*C80 . 25 *		f _T : 14 MHz t _{on} : 250 ns t _{off} : 1000 ns	3	5
	NPN	Commutazione	V _{CEO} : 15 V	P : 0,15 W	hFE:>30	20	
ASY28		Commidtazione	VCBO : 30 V	T ₁ 85 °C	f _T : 14 MHz	3	1 5
12120	100		IC : 0,2 A	R _{thc} : 200 °C/W	ton : 225 ns		
	TO-5				t _{off} : 775 ns		
	NPN		Impiego e dati teo	nici come ASY28 eccetto		20	1
ASY29			V _{CBO} : 25 V		f _T : 20 MHz	3	5
	TO-5				t _{on} : 185 ns t _{off} : 800 ns		
	10-5				1011 . dou its		
	NPN	Commutazione	VCEO : 15 V	P : 0,14 W	hFE:>50	200	1
ASY75	TQ-5		VCBO : 30 V IC : 0,4 A	T _j : 75 °C R _{thc} : 200 °C/W	fT : 10 MHz	3	5
			355000000V			E STATE OF THE STA	
	PNP	Commutazione Circuiti alim.	V _{CEO} : 60 V V _{CBO} : 100 V	P : 30 W T _C : 45 °C	hpg: 20 - 55 f _T : 0,2 MHz	1900 1900	1 5
ASZ15		Greati alim.	IC : 8 A	T _i : 90 °C	17 . U,2 MH2	1000	9
	TO-3			R _{thc} : 1,5 °C/W			
	PNP	Commutazione	V _{CEO} : 32 V	P : 30 W	hFE: 45 - 130	1000	1
.0746		Circuiti alim.	VCBO : 60 V	Tc : 45 °C	f _T : 0,25 MHz	1000	5
ASZ16			IC : BA	Tj : 90 °C			
	TO-3			R _{thc} : 1,5 °C/W			
ASZ17	PNP		Impiego e dati teo	nici come ASZ16 eccetto		1000	1
136.17	TO-3				f _T : 0,22 MHz	1000	5
4SZ18	PNP		Impiego e dati teo	nici come ASZ17 eccetto	hFE: 30 - 110	1000	1
	TO-3		V _{CBO} : 100 V	1 1000			
	PNP	Ampl. uscita	V _{CEO} : 120 V	P : 10 W	hFE : 12 - 50	10 A	
AU101		orizz. TV	V _{CBO} : 120 V	T _C : 70 °C	f _T :>0,4 MHz	500	2
	TO-3		IC : 10 A	T _j : 90 °C R _{thc} : 2 °C/W			
	10-3			Tithe . I ditt			
	PNP	Deflessione	V _{CEX} : 155 V	P : 10 W	hpE : > 15	10 A 600	2 2
AU103		orizz, TV	V _{CBO} : 155 V	T _C : 75 °C T _i : 90 °C	f _T : 15 MHz	900	2
	TO-3		IC : 10 A	T _j : 90 °C R _{thc} : 1,5 °C/W			
100		-		0 15.19		10 A	1
	PNP	Deflessione orizz, TV	V _{CEX} : 185 V V _{CBO} : 185 V	P : 15 W T _C : 67,5 °C	h _{FE} : > 15 f _T : 15 MHz	500	2
AU104		Olizz, IV	IC : 12 A	T _j : 90 °C			
	TO-3			R _{thc} : 1,5 °C/W	3		
			200.0	P : 23 W	hFE: 15 - 80	6000	1,3
AU106	PNP	Deflessione orizz, TV	V _{C8O} : 320 V I _C : 10 A	P : 23 W T _C : 55 °C	fT : 2 MHz	×	
	TO-3	OFFICE I V	n	T _i :90 °C	*		

GLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (T _B = 25 °C)	SIMI	CARATTERISTICHE a (T _a ≃ 25 °C)	Ic (mA)	V c.
J107	PNP	Deflessione vert. TV	V _{CBO} : 200 v	P : 30 W T _C : 45 °C	hfE: 35 - 120 1 _T : 2 MHz	700	2
	TO - 3			T _j : 90 °C			
U108	PNP	Deflessione orizz, TV	V _{CBO} : 100 V I _C : 10 A	P : 30 W T _C : 45 °C	hpg: 35 - 200	700	2
· 	10 - 3			Tj : 90 °C			
	PNP	Deflessione	V _{CBO} : 100 V	P : 30 W	hFE : 120 - 250	1000	2
U108F	TO - 3	orizz. TV	IC : 10 A	Т _С : 45 °С Т _ј : 90 °С			
	PNP	Ampl, finale TV	V _{C80} : 160 V	P : 30 W	hFE : 20 - 90	1000	2
U110			IC : 10 A	T _C : 55 °C			
	10 - 3			T _j : 100 °C			
	PNP	Deflessione	VCBO : 320 V	P : 23 W	hFE : 15 - 80	6000	1,3
U111	TQ - 3	arizz. TV	IC : 10 A	T _C : 55 °C T _j : 90 °C	f _T 3 MHz		
	10-3						
	PNP	Deflessione	VCBO : 320 V	P : 23 W	hFE : 15 - 40	6000	1,3
U112	TO-3	orizz. TV	IC . 10 A	T _C : 55 °C T; : 90 °C	t _T : 2 MHz		
				1) . 30 . 0			
	PNP	Deflessione	V _{CBO} : 250 V	P : 23 W	hFE: 15 - 80	6000	1,3
U113	TD 2	arizz. TV	IC : 10 A	T _c : 55 °C			
	TO - 3			7 ₁ : 90 °C			
	NPM	Preampl. e	VCEO : 45 V	P : 0,3 W	A hFE: 180 β: 220	2	5
C107		pilota BF	VCBO : 50 V	Tj : 175 °C	B hFE : 290 β : 330) 2 10	5 5
	TO - 18		IC : 0,1 A	R _{1hc} : 200 °C/W	f _T : 300 MHz	70	
3/67	NPN	Preampt, 6	VCEQ : 20 V	P 0,3 W	A hFE : 180 β : 220	2	5
C108		pilota BF	VC80 : 30 V	τ _j : 175 °C	B hFE: 290 β: 330	2	5
CIO			C : 0,1 A	Rthc: 200 °C/W	C h _{FE} : 520 β: 600 f _T : 300 MHz	10	5 5
	TO - 18		<u>. </u>		17 . 300 Winz		-
	NPN	Preampl. BF	V _{CEO} : 20 V	P : 0,3 W	B hFE 290 β : 330	2	5
C109		basso rumore	V _{CBO} = 30 V	Tj : 175 °C	C hFE 520 β : 600		5
	TO - 18		IC : 0,1 A	R _{1hc} : 200 °C/W	1 _T : 300 MHz	10	5
	NPN	Ampl. BF	ACEO : 80 A	P : 0.3 W	hFE : > 30	2	5
C110	IALIA	uso generale	ACBO : 80 A	Tj : 175 °C	f _T 100 MHz	10	5
	TO - 18		IC : 50 mA	R _{thc} : 200 °C/W			
	NPN	Preampl. BF	V _{CEO} : 25 V	P : D,2 W	hpg : 350	1	5
C113	TO		VCBO : 30 V	T _j : 125 °C	β : 350 f _T : 60 MHz	1	5
	TO - 106		I _C : 50 mA	R _{thc} : 200 °C/W	'T oo win	-	
C114	NPN TO 106	Preampl. 8F	Dati tecnici come	BC113			
	TO-106	basso rumore					
	NPN	Preampl, e	VCEO : 30 V	P : 0,3 W	hFE : 145	1	10
C115		pilota BF	V _{CBO} : 40 V	T _j : 125 °C	β : 170	10	10
C115	TO - 105	pilota BF	V _{CBO} : 40 V I _C : 0,2 A	T _j : 125 °C R _{thc} : 125 °C/W	β : 170 1 _T : 40 MHz	10	

SIGLA	TIPO e CONT,	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C)				RISTICHE a 5 °C)			f (MHz
	P. 2000-1-20		559 00000000	2000 Alas Mala (2000)						
	PNP	Impiego generale	VCEO : 40 V	P : 0,3 W			: 100	10	1	
BC116			V _{C8O} : 45 V	T; : 125 °C			: 2	30	10	100
	TO - 105		IC : 0,6 A	R _{thc} : 125 °C/W		fΤ	: 200 MHz			
	NPN	Impiego generale	V _{CEO} : 120 V	P : 0,3 W			: 50	10	10	
BC117		alta tensione	VCBO: 120 V	Tj : 125 °C			: 50	10	5	
100	TO - 105			R _{thc} : 125 °C/W		fΤ	: 40 MHz			
	NPN	Impiego generale	VCEO : 45 V	P : 0,2 W			: 40 - 160	tO	10	
BC118			VCBO : 45 V	Tj : 125 °C			: 3,5	10	15	100
	TO - 106			Athc : 200 °C/W	_	f _T	: 350 MHz			
	NPN	Ampl. uscita BF	V _{CEO} : 30 V	P : 0,8 W		hee	: 100	50	1	
BC119	10000 A-CA	v anniban manifest stat	VCBO : 60 V	τ _j : 200 °C			:>2	50	10	20
	TO - 39			R _{thc} : 35 °C/W		165	20 CN NO		***	-3
-	NPN	Pilota orizz, e	VCEO : 30 V	P : 0,8 W		hee	: 70	10	10	
BC120	141 14	vert. TV	VCBO : 60 V	T _i 200 °C			:>2	50	10	20
00120	TO - 39	VCIL IV	CBO Y WAY	R _{thc} : 58,3 °C			: 40 MHz			
	NPN	Ampl. pilota BF	V _{CEO} : 30 V	P : 0,3 W		bee	: 50	1	1	
BC125	INPIN	compl. BC126	VCBO : 50 V	T _i : 125 °C			: >2	50	10	20
DC 123	TO - 105	Compr. BC126	IC : 0,6 A	A _{thc} : 125 °C/W			: 40 MHz		5.5	
·		A. C. C. DE	B. S. Marriell and D.	BC13E accepted		bec	: 62	1	1	
BC126	PNP	Ampl, pilota BF	Dati tecnici come VCBO : 35 V	BC125 eccetto:			: 200 MHz			
		compl. BC125	ACRO : 22 A			-1				
	NPN	Ampl. pilota 8F	VCEO : 45 V	P : 135 mW		hFE	: 220	2	5	
		basso rumore	VCBO : 50 V	T _a : 45 °C			: 125 - 260	2	5	
BC129			IC : 0,1 A	T _j : 175 °C	8		: 240 - 500	2	5	
	TO - 18					ÍΤ	: 300 MHz	10	5	
	NPN	Ampl. pilota BF	V _{CEO} : 20 V	P : 135 mW		hee	: 220	2	5	
	NPN	basso rumore	VCBO : 30 V	Ta: 45 °C	Α	В	: 125 - 260	2	5	
BC130		Dasso Turriore	IC : 0,1 A	Ti : 175 °C	В	β	: 240 - 500	2	5	
50155					С	β	470 - 900	2	5	
	TO - 18					fΤ	: 300 MHz	10	5	
	NPN		Impiego e dati te	cnici come BC130 eccetto):·		: 400	2	5	
BC131							: 240 - 500 : 470 - 900	2	5 5	
1	TO - 18					ρ.	. 470 - 500			
	NPN	Ampl. BF	V _{CEO} : 25 V	P : 0,2 W			: 220 : 240	7	10	
BC132	TO - 106		V _{CBO} : 30 V	Tj : 125 °C Athc : 200 °C/W			: 40 MHz	•	•	
	NPN	Impiego generale	VCEO : 45 V	P : 0,2 W			: 250 : 230	10 5	10	
BC134	TO - 106		VC8O : 45 V	Tj : 125 °C H _{thc} : 200 °C/W			: 350 MHz	-		

	PNP	Ampl. uscita BF	V _{CEO} : 40 V	P : 0,7 W			: 90	10	10	100
BC139			VCBQ : 40 V	Tj : 200 °C			: 2	50	10	100
	TO - 39		IC : 0,5 A	R _{thc} : 58,3 °C/W		T	: 40 MHz			

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C)			TTERISTICHE a = 25 °C)	a lc (mA)	V _{CE} (V)
BC140	NPN	Ampl, BF basso rumore commut. rapida	VCEO : 40 V VCBO : 80 V	P : 3,7 W T _C : 45 °C T _j : 175 °C	10	hFE: 40 - 100 hFE: 63 - 160 hFE: 100 - 250	100 100 100	
	TO - 39	commut. rapida	IC : 1A	R _{tha} : 220 °C/W	10	f _T :>60	50	10
BC141	NPN	20 20	Impiego e dati teo VCEO : 60 V	nici come BC140 eccet	tto:			
	TO - 39		V _{CBO} : 100 V					,
C142	NPN TO-5	Ampl. pilota ed uscita BF compl. BC143	V _{CEO} : 60 V V _{CBO} : 70 V	P : 0,8 W		hFE:80 f _T :40 MHz	200	
3C143	PNP	Ampl, pilota ed uscita BF	V _{CEO} : 60 V V _{CBO} : 60 V	P : 0,8 W		hFE: 70	200	
	TO - 5	compt. BC142	1030 1 22 1	5				Đ.
BC144	NPN TO-5	Ampl. pilota ed uscita BF compl. BC139	V _{CEO} : 40 V V _{CEO} : 60 V	P:0,8W		hFE: 40 fT : 40 MHz	300	
	NPN	Ampl. pilota BF	V _{CEO} : 45 V	P : 0,25 W	A	hFE: 180 β:>	>125 2	5
IC147	SOT - 25 MM - 12	compl. BC157	V _{CBO} : 50 V I _C : 0,1 A	Tj: 125 °C	В	h _{FE} : 290 β:> f _T : 300 MHz	>240 2 10	5 5
	NPN	Preampt. e pilota BF	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 30 V	P : 0,25 W T _i : 125 °C		hpg: 180 β:> hpg: 290 β:>	>125 2 >240 2	5
BC148	SOT - 25 MM - 12	compl. BC158	IC : 0,1 A	1) . 120 . 0		hFE: 520 β:> f _T : 300 MHz		5
BC149	NPN SOT - 25 MM - 12	Preampl, BF basso rumore compl. 8C159	VCEO : 20 V VCBO : 30 V IC : 0,1 A	P : 0,25 W T _j : 125 °C		hpE: 290 β: > hpE: 520 β: > f _T : 300 MHz		5 6 5
BC153	PNP	Preampl. e pilota BF	V _{CEO} : 40 V V _{CBO} : 40 V	P : 0,2 W T _j : 125 °C		hpe : 135 β : 135	1	5 5
	TO - 106		IC : 0,1 A	R _{thc} : 200 °C/W		f _T : 40 MHz		
BC154	PNP TO - 106	Preampl. BF alto guadagno basso rumore	Dati tecnici come	BC153 eccetto:		hFE: 230 β: 230	1	5 5
· ·								
BC155	NPN .	Ampl. BF	V _{CEO} : 5 V V _{CBO} : 5 V	P:105 mW T ₈ : 45 °C	В	β: 85 - 220 β: 200 - 500	0,5 0,5	1
	TOM - 13		lc : 50 mA	Tj : 125 °C	C	$\beta : 470 - 900$ f _T : > 50 MHz	0,5 2	1 5
	NPN	Ampl. BF	VCEO: 5 V	P : 50 mW		β: 85 - 220 β: 200 - 500	0,5 0,5	1
BC156	TOM - 23		VC80 : 6 V IC : 50 mA	Ta: 45 °C Ti: 125 °C		β: 200 - 500 β: 470 - 900 f _T : > 50 MHz	0,5 2	1 5
BC157	PNP SOT - 25 MM - 12	Ampl. pilota BF compl. BC147	VCEO : 45 V VCBO : 50 V IC : 0,1 A	P : 0,25 W T _j : 125 °C		hee: 140 β:> hee: 180 β:> f _T : 150 MHz		5 5 5

(47 RSTT)

SIGLA	TIPO	IMPIEGO	VALORI MA			ATTERISTICHE a	lc	Vo
	CONT.		(T _a = 25 °C	c)		T _a = 25 °C)	(mA)	,
	PNP	Preampl, e	VCEO : 25 V	P : 0,25 W	VI	hFE:140 β:> 75	2	
3C158		pitota BF	VCBO : 30 V	Ti : 125 °C		hFE: 180 β:>125	2	5 5
3C 100	SOT - 25	compl. BC148	IC : 0,1 A	.,	В	hFE:290 β:>240	2	
	MM - 12	A DESTRUCTION OF THE PROPERTY				f _T : 150 MHz	10	5 5
	PNP	Preampl, BF	V _{CEO} : 20 V	P : 0,25 W	Α	hpg:180 β:>125	2	5
3C159	SOT-25	basso rumore	VC80 : 25 V	Tj : 125 °C	В	hFE: 290 β:>240	2	5
	MM - 12	compl. BC149	IC : 0,1 A			f _T : 150 MHz	10	5
	NPN	Preampl. e	VCEO : 45 V	P : 0,22 W		hFE: 220	2	5
3C167	TO 000	pilota BF	VCBO : 50 V	Tj: 125 °C	Α	· III · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	5
	TO-92B MM-11B	basso rumore compl. BC257	IC : 0,1 A		В	β : 240 - 500 f _T : 300 MHz	2 10	5 5
- 101	NPN	Preampl, e	Voca : 20 V	D - 0.00 W				
	511.65	pilota BF	VCEO : 20 V	P : 0,22 W		hFE: 220	2	5
3C168		basso rumore	V _{CBO} : 30 V	Tj : 125 °C	A	A SALE MANAGEMENT AND	2	5
	TO - 92B	compl. BC158	IC : 0,1 A			β : 240 - 500	2	5
	MM-11B	W. 20130			С	β : 470 - 900 f _T : 300 MHz	2 10	5 5
	NPN	Preampl, e	Dati tecnici com	BC168 eccetto:		hFg : 400	2	5
		pilota BF			В	β : 240 - 500	2	5
3C169	TO-92B	basso rumore			c	β : 470 - 900	2	5
	MM-11B		9		·	p 1470 500	•	•
	NPN	Ampl. RF-FI	VCEO : 20 V	P:0,2 W		hFE: 35 - 100	1	
		per AM - OC			Α	hFE: 35 - 100	1	
C170		Commutazione			В	hFE: 80 - 250	1	
					С	hpg: 200 - 600	1	
	TO - 92					f _T : 100 MHz		
	NPN	Ampl. RF - FI	V _{CEO} : 45 V	P : 0,2 W		hpe : 275	2	
IC171		per AM-OC				hFE : 225	20	
	TO - 92				В	հբ E : 350 f _T : 300 MHz	20	
	NPN	Ampl, RF - FI	V _{CEO} : 20 V	P : 0,2 W		hFE : 225	20	
	141.14	per AM - OC	VCEO - 20 V	r . 0,2 H		hFE : 225	20	
IC172		per Am-00			B		20	
					100	hFE: 620	20	
	TØ - 92					f _T : 300 MHz	20	
	PNP	Preampl. e	V _{CEO} : 45 V	P : 0,3 W	v	hFE: 75 β:> 50	2	5
		pilota BF	VCBO : 50 V	T; : 175 °C		hFE: 140 β:> 76	2	5
C177		compl. BC107	IC : 0,1 A	Rthe : 200 °C/W		heE: 180 β:>125	2	5
				The second second	В	hFE: 290 β:>240	2	5
101	TO - 18	-			-	f _T : 130 MHz	10	5
rand	PNP	Presmpl. e	Dati tecnici come	BC177 eccetto:			meri =	
C178	TO - 18	pilota BF compl. BC108	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 30 V					
-	PNP	Preampl, BF	V _{CEO} : 20 V	P : 0,3 W	Δ	hgE: 180 β:>125	2	5
C179	8.655	basso rumore	VCBO : 25 V	T _i : 175 °C		hFE: 290 β:>240	2	5
	TO - 18	compl. BC109	IC : 0,1 A	R _{thc} : 200 °C/W		f _T : 130 MHz	10	5
			ig :U,IA	"the . 200 "C/M		T . 130 MIZZ	10	_

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO (VALORI MAS (T _a = 25 °C			TTERISTICHE a T _a = 25 °C)	Ic (mA)	V c (V
BC183	NPN TO - 18	Ampl. RF - MF	V _{CEO} : 30 V	P : 0,3 W		hFE : < 85 f _T : 150 MHz	2	
	NPN	Applicazioni	V _{CEO} : 25 V	P : 0,1 W		hpe : > 25	1	10
3C194	TOM-13	generali RF Commutazione	V _{CBO} : 40 V I _C : 0,8 A	T _a : 45 °C T _j : 125 °C		f _T : > 250 MHz	20	10
	NPN	Impiego	V _{CEO} : 45 V	P : 50 mW		hFE: 220	2	5
IC197		generale BF	VCBO : 50 V	Ta: 45 °C	Α	β : 125 - 260	2	5
JC 197			IC : 0,1 A	Tj : 125 °C	В	β : 240 - 500	2	5
_	TOM-23	·				f _T : 300 MHz	10	5
	NPN		Impiego e dati ter	cnici come BC197 eccett		β:125 - 260	2	5
3C198			VCEO : 20 V			β : 249 - 500	2	5
1#K	TOM-23		V _{CBO} : 30 V		С	β: 470 - 900 f _T : 300 MHz	2 10	5 5
	10111-23					17 . 300 WHZ		
	NPN	Impiego	VCEO : 20 V	P : 50 mW		hFE : 400	2	5
3C199		generale BF	V _{CBO} : 30 V	T _a : 45 °C		β : 240 - 500	2	5
	TOM-23		IC : 0,1 A	T _j : 125 °C	С	β : 470 - 900 f _T : 300 MHz	2 10	5 5
			100 D				•	2000
	PNP	Preampl. e	VCEO : 45 V	P : 0,3 W		h _{FE} : 75 β:> 50		5
DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF		pilota BF	VCBO: 45 V	T _j : 125 °C		hFE: 110 β:> 75	2	5
3C204	TO-92		IC : 0,1 A			hpg: 180 β.>125		5
	TO - 106 RO - 110				В	h _{FE} : 290 β:>240 f _T : 200 MHz	2 10	5 5
	PNP	Preampl. e	Dati tecnici come	BC204 eccetto:				
BC205	TO - 92	pilota BF	VCEO : 20 V					
	TO - 106 RO - 110		V _{CBO} : 20 V					
	PNP	Preampl. BF	VCEO : 20 V	P : 0,3 W	В	hFE : 290	2	5
BC206	TO - 92	basso rumore	VCBO : 20 V	Tj : 125 °C		β :>240	2	5
50200	TO - 106 RO - 110		IC : 0,1 A			f _T : 200 MHz	10	5
-	NPN	Preampt, e	VCEO : 45 V	P: 0,3 W	A	hFE: 180 β: 200	2	5
1C207	TO-92	pilota BF	VCBO: 45 V	Tj : 125 °C	В	hFE: 290 β: 330	2	5
3C2U/	TO-106		IC : 0,1 A	**		β : 200 - 330	2	5
	RO-110					f _T : 300 MHz	10	5
	NPN	Preampl. e	V _{CEO} : 20 V	P : 0,3 W		hFE: 180 β: 200	2	5
BC208	TO-92	pilota BF	V _{CBO} : 20 V .	Т _ј : 125 °С		hFE:290 β:330	2	5
~~~~	TO-106		IC : 0,1 A		С	hFE:520 β:600	2	5
	RO-110					f _T : 300 MHz	10	5 .
	NPN	Preampl, BF	V _{CEO} : 20 V	P : 0,3 W		heE:290 β:330	2	5 5
BC209	TO-92	basso rumore	У _{СВО} : 20 V	Tj : 125 °C	C	hpg:520 β:600	2 10	5
	TO-106 RO-110		IC : 0,1 A			f _T : 300 MHz	10	5
	NPN	Pilota orizz, e	V _{CEO} : 26 V	P : 0,45 W		hFE: 30 - 140	10	1
	PALM	vert. TV	VCEO : 25 V	T; : 175 °C		f _T : 250 MHz	20	10
BC210		TGIL. I Y	IC : 0,7 A	Rthc: 100 °C/W		ton : 30 ns	150	
	TO-18			urc		t _{off} : 180 ns	150	

SIGLA	TIPO B CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS {T _a = 25 °C}	SIMI		TTERISTICHE : a = 25 °C)	(mA)	V _{CE}
	NPN	Pilota orizz. e	VCEO : 25 V	F : 0,6 W		hFE: 30 - 140	10	1
BC210A		vert. TV	VCBO : 50 V	Tj : 175 °C		f _T : 250 MHz	20 150	10
	10-5		IC : 0,7 A	R _{thc} : 60 °C/W		t _{on} : 30 ns t _{off} : 180 ns	150	
-	NPN	Pilota orizz, e	V _{CEO} : 40 V	P : 0,8 W		hpe : 70	10	1
BC211		vert. TV	VCBO : 80 V	Tj : 175 °C		f _T : 200 MHz	50	10
DOZ ( )	TO-5		IC : 1 A	Ritho: 35,ºC/W		t _{on} : 30 ns t _{off} : 180 ns	150 150	
					<u> </u>		150	
BC215	PNP	Impiego generale	VCEO : 30 V	P : 0,4 W		hpe : 40 - 120	150 150	10 10
BC215	TO-18		VCBQ : 50 V IC : 0,5 A	Tj : 200 °C R _{thc} : 140 °C/W		hpe: 100 - 300 f _T : 200 MHz	30	10
	PNP	Preampl, e	V _{CEO} : 40 V	P : 0,2 W		hFE: 170	1	5
BC225		pilota BF	VCBO : 40 V	Tj : 125 °C		β : 185	1	5
	TO-106		IC : 0,1 A	R _{thc} : 200 °C/W				
BC236	NPN	Impiego generale	V _{CBO} : 120 V	P : 0,3 W		hFE: > 25	10	10
	RO - 110	alta tensione	IC : 50 mA	T _j : 125 °C		β :>25	10	5
	NPN		Impiego e dati teci	nici come BC147 eccet	rto:			
BG237	TO -92 MM - 11			P:0,3W				
	NPN		Implego e dati tec	nici come BC148 eccet	ito:	<del></del>		
BC238	TO - 92 MM - 11			P : 0,3 W			No	
BC239	NPN TO - 92 MM - 11		Impiego e dati teo	nici come BC149 eccet P : 0,3 W	tto:			
	PNP	Preampl, e	V _{CEO} : 45 V	P : 0,22 W	VI	h _{FE} : 110 β:> 1	75 2	
BC257		pilota BF	VCBO : 50 V	Tj : 125 °C	Α	hFE: 180 β:>1		
	TO-92B	compl. BC167	IC : 0,1 A			f _T 1.130 MHz	10	5
	PNP	Preampl. e	V _{CEO} : 25 V	P : 0,22 W		hpg: 110 β:>		
BC258		pilota BF	VCBO : 30 V	Tj: 125 °C		hFE: 180 β:>15 hFE: 290 β:>2		
	TO-92B	compl. BC168	IC : 0,1 A			i _T : 130 MHz	10	5
	PNP	Preampl, e	VCEO : 20 V	P : 0,22 W	Α	hFE:180 β:>1	25 2	
BC259	FIAE	pilota BF	VCBO : 26 V	Ti : 125 °C		hFE:290 β:>2		
	TO-92B	compl. BC169	IC : 0,1 A	a energy to		f _T : 130 MHz	10	5
	NPN	Ampl. pilota BF	VCEO : 45 V	P : 0,375 W		β:125 - 500	2	5
BC267	TO - 18	Commutazione	VCBO: 50 V IC: 0,5 A	т _ј : 175 °С		f _T : 200 MHz		
	NPN	Ampl. pilota BF	V _{CEO} : 20 V	P : 0,375 W		β : 125 - 900	2	5
BC268	INCIN	alto guadagno	VCBO : 30 V	Tj : 175 °C		f _T : 200 MHz		
	TO - 18	Commutazione	IC : 0,5 A					
	NPN	Preampl. BF	Dati tecnici come	DOTED ASSESSED		β: 240 - 900	2	5
BC269		basso rumore	Dati tecnici come					

IGLA	TIPO 8 CONT.	IMPLEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	EMI		TTERISTICHE 8 a = 25 °C)	Ic (mA)	V _{CE} (V)
Ç270	NPN	Ampl. pilota BF	Dati tecnici come	BC268 eccetto:		β:50-900	2	5
	TO - 18	Commutazione	V _{CBO} : 20 V	.,		<u> </u>		
	NPN	Preampl. BF	V _{CEQ} : 40 V	P : 0,36 W	A	hFE: 200 β: 220	1	5
C280		basso rumore	VCBO : 45 V	Tj : 200 °C	B-C	hFE: 350 β: 370	1	5
	TO - 18		I _C : 0,1 A	R _{thc} : 146 °C/W		<u> </u>		
	PNP	Preampl. BF	V _{CEO} : 45 V	P : 0,36 W	A	h _{FE} : 120 β: 130	1	5
C281		basso rumore	VCBO : 45 V	Tj : 200 °C	В	h _{FE} : 200 β: 200	1	5
	TQ - 18		IC : 0,2 A	Rthc: 146 °C/W	С	heE: 250 β: 250	1	5
	NPN	Ampl. pilota e	V _{CEO} : 30 V	P ; 0,4 W		hpg : 150	50	6
C282	170.00	finale BF	VCBO : 60 V	Tj : 200 °C		β : 170	50	5
10242	TO-18	compl. BC283	IC : 0,6 A	Rttic : 134 °C/W				
	PNP	Ampi, pilota e	V _{CEO} : 30 V	P : 0,4 W		hpg : 130	50	5
BC283	PHT.	finale BF	V _{CBO} : 30 V	Tj : 200 °C		β : 110	50	5
30203	TO - 18	compl. BC282	IC : 0,6 A	R _{thc} : 134 °C/W				
		Ampl. pilota BF	VCEO : 40 V	P : 0.5 W	Α.	h _{FE} : 230 β: 265	10	10
BC284	NPN	Ampi, priora or	VCBO : 40 V	Tj : 200 °C	В	hFE: 360 β: 390	10	10
2C204	TO - 18		IC : 0,2 A	R _{thc} : 97 °C/W				
	AIDAI	Preampl, e	VCEO : 120 V	P : 0,36 W		hFE : 70	5	30
BC285	NPN	pifota BF	VCBO : 120 V	Ti : 200 °C		β : 70	5	30
50285	TO-18	alta tensione	IC : 0,1 A	R _{thc} : 146 °C/W				
	NPN	Ampl. uscita BF	VCER : 60 V	P : 0,8 W		hFE: 170	10	2
	MEN	Ampi. uscrae or	(RBE : <200 Ω	) Ti : 200 °C		β : 120	100	2
BC286			VCBO : 70 V	R _{thc} : 43,7 °C/W				
	TO-39		IC : 1 A					
	PNP	Ampl, uscita BF	V _{CEO} : 60 V	P ; 0,8 W		hFE: 90	100	2
BC287	FINE	Alithi, ascita o	VCBO : 60 V	Ti : 200 °C		β :90	100	2
	TO - 39		IC : 1 A	R _{thc} : 43,7 °C/W				
	NPN	Ampl, uscita BF	V _{CEO} : 40 V	P : 0,8 A		hFE : 150	100	2
BC288	INFIN	Authi, dance of	VC80 : 80 V	т _ј : 200 °С		β : 145	500	2
66200	TO - 39		IC : 5 A	Rthc: 25 °C/W				
		A-ul situto a	V _{CEO} : 45 V	P : 0.375 W		hpE: 75 - 260	100	1
0.0007	PNP	Ampl. pilota o finale BF	VCBO : 50 V	Ti : 175 °C		fT : 150 MHz		
BC297	TO-18	Commutazione	IC : 1 A			there are		
-		A-ol pilota -	V _{CEO} ; 25 V	P : 0,375 W		hFE: 75-500	100	1
DC200	PNP	Ampl. pilota o finale BF	VCBO : 30 V	Ti : 175 °C		fT : 150 MHz		
BC298	TQ - 18	Commutazione	IC : 1 A					
	NPN	Ampl. pilota BF	V _{CEO} : 80 V	P ; 6W		hFE: 40 - 240	150	10
BC300	NEN	Commutazione	VCBO : 120 V	T _C : 25 °C		f _T : 120 MHz		
20300	TO - 39		IC : 0,5 A	Tj : 175 °C				
	MPN		Impiego e dati te	ecnici come BC300 eco	etto:			
BC301	y4F-14		VCEO : 60 V					
DOWN !	TO - 39		VCBO: 90 V					

iiGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO VALORI MASSI (Ta = 25 °Cl		IMI		reristiche = 25 °C)	a 1 _C (mA)	V _{CE} (V)
3C302	NPN		Impiego e dati tecn VCEO : 45 V VCBO : 60 V	ici come BC300 eccett	и [*] 0:			
_	TO - 39		*CBO : 55 *					
3C303	PNP TO - 39		Impiego e dati tecn VCEO : 60 V VCBO : 85 V	ici come BC300 eccett	o: f	T : 75 MHz		
	PNP			nici come BC300 eccett	to: 1	t _T : 75 MHz		
3C304	TO - 39		V _{CEO} : 45 V V _{CBO} : 60 V	0				
	PNP	Ampl. BF	V _{CEO} : 45 V	P : 0,3 W	VI I	hFE: 75 - 150	2	5
3C307	MNP	Ampi. 9r	VCBO : 50 V	T _j : 125 °C	Α	hpe : 125 - 260	. 2	5
,0301	TQ-92		I _C : 0,1 A			f _T : 150 MHz	10	5 
		A DE	V _{CEO} : 25 V	P : 0,3 W	VI	hee: 75 - 150	2	5
	PNP	Ampl. BF	VCBO : 30 V	Ti : 125 °C	A	hFE: 125 - 260	2	5
BC308			IC 0,1 A		В	hFE: 240 - 500	2	5
	TO - 92					f _T : 150 MHz	10	
	PNP	Ampl. BF	V _{CEO} : 20 V	P : 0,3 W		hFE : 125 - 260	2	
BC309			VCBO : 25 V	т _ј : 125 °С		hpg : 240 - 500	2	
	TO - 92		IC : 0,1 A			f _T : 150 MHz	10	
_	PNP	Pilota orizz, e	V _{CEO} ; 40 V	P : 0,8 W		hFE: 70	10	
BC313		vert, TV	VCBO : 70 V	Tj : 175 °C		fT : 200 MHz	50	10
	TO - 5	uscita BF	ic : 1 A	R _{thc} : 35 °C/W				
	NPN	Preampl. BF	VCEO : 45 V			hFE: 125 - 500	2	
BC317		***************************************		4		hpg: 125 - 260	2	
	TO - 92A					hFE : 240 - 500		
	NPN	Preampl. BF	V _{CEO} : 30 V			hpe : 125 - 900		
BC318	MHM	гтеаттр. от	TOED THE			hFE: 125 - 260		
	TO-92A				В	hFE: 240 - 500		
BC318C	NPN TO - 92A	Preampl, BF	V _{CEO} : 20 V			hpg : 450 - 900		! 
			V 20 V			hpe : 240 - 900	2	į
	NPN	Preampl, BF	VCEO : 20 V			hFE: 250 - 500	. 2	
BC319	TO - 92A				C	hpE : 450 - 900		<i>!</i>
ВС323	NPN TO - 39	Ampl. finale vert. TV	VCEO : 60 V	P:0,8W				
BC324	NPN TO - 39	Ampl. finale vert. TV	VCEO : 55 V VCBO : 85 V	P:0,8 W		ě		
			Veca 50 V	P : 0,5 W		hFE: 100 - 600	) 10	
000-0	PNP	Ampl. finale BF compl. BC337	VCES : 50 V VCEO : 45 V	Ti : 150 °C		f _T : 100 MHz		0 5
BC327	TO - 92	compr. beaut	IC : 0,5 A	R _{thc} : 170 °C/W				

SIGLA	CONT.	IMPLEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)	(mA)	V _{CI} (v)
	PNP	Ampl. finale BF	Dati tecnici come BC327 eccetto:	5		
BC328	TO - 92	compt. BC338	V _{CES} : 30 V V _{CEO} : 25 V			(16)
	NPN	Ampt, finale BF	VCES : 50 V P : 0,5 W	hpg : 100 - 600	100	1
BC337	TO - 92	compl. BC327	VCEO : 45 V T _j : 150 °C IC : 0,5 A R _{thc} : 170 °C/W	f _T ± 200 MHz	10	5
-	NPN	Ampl. finale BF	Datí tecnici come 8C337 eccetto:			
BC338	TO -92	compl. BC328	VCES : 30 V VCEO : 25 V			
	PNP	Ampl, pilota BF	V _{CEO} : 20 V P : 0,375 W	hFE : 50 - 500	to	_ 5
BC370	TO - 18	Commutazione	VCBO : 20 V T _i : 175 °C IC : 0,5 A	f _T : 150 MHz		
	NPN	Ampl. pilota BF	V _{CEO} : 45 V P : 0,375 W	hFE: 75 - 500	100	1
BC377	TO - 18	Commutazione	V _{CBO} : 50 V T _j : 175 °C IC : 1 A	f _T : 200 MHz		
	NPN	Ampl. pilota BF	V _{CEQ} : 25 V P : 0,375 W	hFE: 75 - 500	100	1
BC378	TO-18	Commutazione	V _{C8O} : 30 V T _j : 175 °C I _C : 1 A	f _T : 200 MHz		
	NPN	Ampi, pilota	V _{CEO} : 70 V P : 0,3 W			
BC395	TO - 39	Deflessione vert. TV	VCBO : 80 V			
BC396	PNP TO - 39	Ampl. finate	Dati tecnici come 8C393			
	PNP	Ampl. alta tensione	V _{CEO} : 80 V P: 0,36 W	hFE : 160	2	
BC404	TQ-92		VCBO : 80 V IC : 0,15 A	., 2		
	PNP	Preampl. BF	V _{CBO} : 60 V P : 0,36 W	hFE : 195		
BC405	TO -92	basso rumore	IC : 0,15 A		200	
BC406	PNP TO-92	Preampi, BF bassissimo rumore	V _{CBO} : 40 V P: 0,36 W I _C : 0,15 A	hFE : 290		
	NPN	Ampl. BF	VCEO : 40 V P : 10 W	hFE : 40 - 250	500	4
BC440	TO - 39	media potenza Commutazione	V _{CBO} : 50 V	f _T :>50 MHz		
	NPN		Impiego e dați tecnici come BC440 eco	etto:		
BC441	TO - 39		V _{CEO} : 60 V V _{CBO} : 75 V			
	PNP		Impiego e dati tecnici come BC440 eco	etto:	·-	-
BC460	TO - 39		V _{CEO} : 40 V V _{CEO} : 50 V			
	PNP		Impiego e dati tecnici come BC440 ecca	etto:		e e
BC461	TO-39		V _{CEO} : 60 V V _{CBO} : 75 V			

SIGLA	TIPO 6 CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	SIMI	CARA (T	TTERISTICHE a = 25 °C)		V _{CE} ) (V)	f (MHz
BC507	NPN TO - 92	Preampl. BF basso rumora	V _{CBO} : 70 V I _C : 0,2 A	P : 0,36 W		hFE : 230	2		
BC508	NPN TO - 92	Preampl. BF basso rumore	V _{CSO} : 60 V I _C : 0,2 A	P : 0,36 W		hFE : 350	2		
BC509	NPN TO - 92	Preampl. BF bassissimo rumore	V _{CBO} : 60 V I _C : 0,2 A	P : 0,36 W		hFE : 195			
BC510	NPN TO - 92	Preampl. BF bassissimo rumore	V _{CBQ} : 40 V	P : 0,36 W		hFE : 196			
BD 109	NPN SOT-9	Ampl. BF di potenza Commutazione	VCEQ : 40 V VCBO : 60 V IC : 3 A	P : 18,5 W Tc : 45 °C Tj : 176 °C Rthc : 7 °C/W		hFE: 30 - 90 hFE: 50 - 150 hFE: 100 - 300 β: 30 - 300 f _T : > 30 MHz	1000 1000 1000 1000 200	2 2 2 2 10	139
BD111	NPN TO-3A	Ampl, finale vert. TV	VCEO : 60 V VCBO : 60 V IC : 10 A (impulso di 10 μs)	P : 15 W T _C : 75 °C T _j : 150 °C R _{thc} : 5 °C/W		hFE:100 β:5	500 500	10 5	20
BD115	NPN TO - 39	Ampl. BF e video TV pilota stadi Deflessione TV	V _{CEO} : 180 V V _{CBO} : 245 V I _C : 0,15 A	P : 6 W T _a : 50 °C con diss. alluminio 30 cm², spessore 1,5 m T _j : 200 °C R _{tha} : 200 °C/W R _{thc} : 12,5 °C/W	m	hFE: 60 f _T : 145 MHz		100 100	
BÐ116	NPN TO-3A	Ampl, finale BF	VCEO : 60 V VCEO : 80 V IC : 3 A	P : 20 W T _C : 50 °C T _j : 150 °C Rthc : 5 °C/W	****	hFE: 120 β: 2,3	200 200	10 10	20
BD117	NPN TO-3A	Ampl. BF di potenza	V _{CEO} : 50 V V _{CBO} : 100 V	P : 30 W T _C : 25 °C T _j : 150 °C R _{thc} : 3,33 °C/W		hfe : 70	50	5	
BD118	NPN TO-3A	Regulatore di tensione	V _{CEO} : 60 V V _{CBO} : 80 V	P : 20 W T _C : 50 °C T _j : 150 °C R _{thc} : 5 °C/W		hFE: 90 β:>1,5	100 200	5 10	20
3D 124	NPN SOT - 9	Finale BF	VCEO : 45 V VCBO : 70 V IC : 2 A	P : 15 W Tc : 62,5 °C Tj : 175 °C Rthc : 7,5 °C/W		hẹė : 60 f _T : 120 MHz	50 250	5 5	
BD 127	NPN SOT - 9	Finale vert. <b>T</b> V	VCEO : 300 V VCBO : 350 V IC : 0,15 A	P : 16,5 W T _C : 25 °C T _I : 175 °C		hjee : 70 f _T : 20 MHz	50 50	20 20	

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	IMI		TTERISTICHE a = 25 °C)		lc nA)	<b>V</b> c. (V
BD 128	NPN	Impiego generale di potenza e	Dati tecnici come I VCEO : 350 V	BD127 eccetta:		hFE : 50		50	20
	SOT-9	alta tensione	V _{CBO} : 400 V						
BO 129	NPN SOT-9		Impiego e dati tecn VCBO : 350 V	ici come BD128 eccetto	):	hFE : > 10 MHz		50	20
	NPN	Pilota BF	V _{CEO} : 45 V	P : 6,5 W	6	hFE: 40 - 100	t	50	2
BD 135		compl. BD136	VCBO : 45 V	T _C : 60 °C		hFE: 63 - 160	1	50	2
30.40			IÇ : 0,5 A	Tj : 125 °C	16	hFE: 100 - 250		50	2
	TO - 126			R _{thc} : 10 °C/W		f _T : 250 MHz		50	5
BD 136	PNP TO - 126	Pilota BF compl. BD135	Dati tecnici come f	3D135 eccetto:		f _T : 75 MHz		50	5
	NPN	Pilota BF	VCEO : 60 V	P : 6.5 W	6	hFE: 40 - 100	4	50	
		compl. BD138	VCBO : 60 V	T _c : 60 °C		hFE: 63 - 160		50	2
BD137		=	IC : 0,5 A	Tj : 125 °C	-	fT : 250 MHz		50	5
	TO - 126			R _{thc} : 10 °C/W					
3D138	PNP TO-126	Pilota BF compl. BD137	Dati tecnici come i	3D137 eccetto:		f _T :75 MHz	3.00.00	50	5
							017 8781-21-		_
	NPN	Pilota BF	Dati tecnici come I	3D137 eccetto:					
BO 139	TO - 126	compl. BD140	VCEO : 80 V						
· -	PNP	Pilota BF	Dati tecnici come il	BD137 eccetto:		f _T : 75 MHz		50	5
BD140		compl. BD139	VCEO : 80 V			,			
	TQ - 126		VCBO : 80 V						
	NPN	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 120 V	P : 117 W		hFE : 20 - 70	20	00	4
BD141		Commutazione	VCBO : 140 V	Tc : 25 °C					
	TO-3		IC : 8 A	Tj : 200 °C					
	NPN	Ampl. finale BF	VCEO : 40 V	P : 117 W		hee : 12,5 - 160	40	nn	4
BD142	NEN	Commutazione	VCBO : 50 V	Tc : 25 °C		f _T : 1,3 MHz	40		
	TO - 3		Ic : 15 A	Tj : 200 °C					
	4.041	A CONTRACT		D . DW		han 1 > 20	20	00	20
	NPN	Circuiti defless, vert, TV	V _{CER} : 400 V (R _{BE} : ≤500 Ω)	P: 8 W T _C : 95 °C		hFE: >20 fT: 12 MHz		50 50	5
9D144		Ucticas. Vett. IV	VCBO: 400 V	T; :135 °C				••	_
	TQ-3		IC : 0,25 A	Rthc: 5 °C/W					
									10
	NPN	Circuiti	VCEO : 60 V	P : 15 W		hpg:>45		00 00	10 5
BD 145		defless, orizz. TV	VCBO:60V IC:5A	T _C : 100 °C . T _j : 175 °C		f _T : 100 MHz	01		3
	TO - 3		10 9 M	R _{thc} : 5 °C/W					
			**						_
	NPN	Ampl. finale 8F	VCEQ : 20 V	P : 23 W		hFE: 40 - 180	50	00	2
BD 162		Commutazione	VC80 : 40 V	Tc : 60 °C		f _T :>0,8 MHz			
	SOT - 9		IC : 4 A	т _ј : 200 °С					

ŞIGLA	TIPO B CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS {T _a = 25 °C)	IMI	CARATTERISTICHE a {Ta = 25 °C}	Ic (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz
BD163	NPN		Impiego e dati tech VCEO : 40 V	ici come BD162 eccetto	o [.]			
DD 100	SOT-9		VCBO : 60 V					
	NPN	Ampl. BF	V _{CEO} : 60 V	P : 37,5 W	hFE : 20 - 70	4000	4	
BD 191	SOT - 9	di potenza Commutazione	V _{CBO} : 100 V I _C : 15 A	T _C : 25 °C T _j : 175 °C	f _T :>0,8 MHz			
	NPN		AND ARREST CONTRACTOR OF COMMENTS REPROCESS	ici come BD191 eccett		,		
BD 192	SOT-9		V _{CEO} : 40 V V _{CBO} : 50 V		hFE:12,5-160 f _T : 1,3 MHz	4000	4	4
	NPN	Ampl. BF	V _{CEO} : 120 V	P : 37,5 W	hFE : 20- 70	2000	4	
BD193	SOT-9	di potenza Commutazione	VCBO: 140 V IC: 8 A	T _C : 25 °C T _j : 175 °C				
	NPN	Ampl. BF	VCEO : 300 V	P : 21,5 W	hFE:>40	100	10	5
BD215	SOT-9	di potenza Commutazione	V _{CBO} : 500 V I _C : 0,5 A	т _с : 25 °С Т _ј : 175 °С	f _Υ : 10 MHz ·			
	NPN	Ampl. BF	V _{CEO} : 200 V	P : 21,5 W	hee : 40 - 150	100	10	
BD216	SOT-9	di potenza Commutazione	V _{CBO} : 300 V I _C : 1 A	T _C : 25 °C T _j : 175 °C	f _T : 10 MHz			
(	NPN	Ampl. finale	V _{CEO} : 110 V	P : 0,6 W	hFE:>20	10	10	
BF109	TO-5	video TV Commutazione	V _{CBO} : 135 V I _C : 50 mA	T _C : 100 °C T _j : 175 °C	f _च : 135 MHz	10	10	
	NPN	Ampl. finale	V _{CES} : 160 V	P : 2,5 W	hfE:>30	10	10	
BF110		video TV	IC : 40 mA	T _C : 25 °C T _j : 200 °C	f _T : 150 MHz	10	10	
	TO-39			R _{tha} : 250 °C/W			-	or to
	NPN	Ampl, video per TV color	V _{CER} : 200 V (R _{BE} : ≤ 1 kΩ)	P : 3 W T _C : 100 °C	hFE : >20 f∓ : 120 MHz	60 20		
BF111	TO - 39	0 3000 No 10 10 10000000	IC : 80 mA	T _j : 175 °C R _{tha} : 200 °C/W	·			
-	NPN	Ampl. finale	VCEO : 130 V	P : 0,59 W	hpE : >30	10	10	
BF114	3411	video TV	VCBO : 160 V	T _a : 45 °C T _i : 175 °C	f _T :>80 MHz	10	10	
	TO-5			R _{thc} : 60 °C/W				
	NPN	Ampl. RF AM-FM	V _{CEO} : 30 V	P : 0,145 W	hFE: 47 - 165 Yfe: 30 mS	1 1	10 10	100
BF115		Ampl. 8F basso rumore	VCBO:50 V IC:30 mA	T _a : 45 °C T _j : 175 °C	f _T : 230 MHz	1	10	
	TO - 72R				f _β : 1 MHz			
BF117	NPN TO-5	Ampt. finale video TV	V _{CEO} : 140 V	P : 1,2 W	hpE:>25 fT:100 MHz	30		
	TO - 39	TIMOU I T						
25.55	NPN	Oscill. conv. TV-FM		P : 0,2 W	hFE: 50 β : 8	3	10 10	ï
BF162	TO - 106		V _{CBO} : 30 V	T _j : 125 °C R _{thc} : 200 °C/W	ρ : 8 f _T :600 MHz	-	10	75

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (T _a = 25 °C)	SIMI	CARATTERISTICHE a (T _a = 25 °C)		VCE (V)	f (MH
	NPN	Ampl, FI-AM	V _{CED} : 12 V	P : 0,2 W	hFE : 50	3	6	
BF163			VCBO : 30 V	Tj : 125 °C	β : 4	3	6	100
105	TO - 106			R _{the} : 200 °C/W	G _{tr} ∶ 44 dB f _T ∶ 400 MHz	3	6	0,47
	NPN	Ampl. pilota	V _{CEO} : 20 V	P : 0,3 W	hpg : 50	10	10	-
BF154		video TV	VC80 : 30 V	T _i : 125 °C	β : 4	2	10	100
	TO - 105		1907011 \$40040	R _{thc} : 125 °C/W	f _T : 400 MHz			
	NPN	Oscill. conv. UHF	V _{CEO} : 40 V	P : 175 mW	hFE: 70	2,5	12	
3F 155	TO - 72		V _{CBQ} : 40 V Ic : 20 mA	Tj : 175 °C R _{thc} : 580 °C/W	β : 6 1 _T :400 MHz	2,5	12	100
	AIRM	American Standards	V 100 V	B . 0.0 W				
BF 156	NPN TQ-5	Ampl. finale video TV	V _{CEO} : 120 V V _{CBO} : 120 V	P:0,8 W				
	NAME	And Pers	V 150 V	P : 0,8 W		<u> </u>		
BF 157	NPN TO - 5	Ampt. finale video TV	VCEO : 150 V VCBO : 150 V	P : U,S W				
	NPN	Ampl. FI - TV	V _{CEO} : 12 V	P : 0,2 W	hFE : 50	4	10	
BF 158			VCBO : 30 V	Tj : 125 °C	β : 8	5	10	100
JF 130				R _{thc} : 200 °C/W	G _{fr} : 26 dB	5	10	40
	TO - 106	<u>-</u>			f _T : 600 MHz			
	NPN	Ampl. FI - TV	VCEO : 20 V	P : 0,2 W	hFE: 50 β : 8	<b>4</b> 5	10 10	100
BF 159			V _{CBO} : 40 V	T; : 125 °C R _{the} : 200 °C/W	ρ : δ G _{tr} : 26 dΒ	5	10	40
	TO - 106			Title 1 232 Zin	f _T : 600 MHz			
	NPN	Ampl. F1	V _{CEO} : 12 V	P : 0,2 W	hFE: 50	3	10	
BF 160		per AM - FM	VCBO: 30 V	т _ј : 125 °С	β : 6	3	10	100
or iço				R _{thc} : 200 °C/W	G _{tr} : 32 dB	3	8	10,7
	TO-106				f _T : 400 MHz			
	NPN	Oscill. conv UHF	V _{CEO} : 50 V	P : 175 mW	hFE : 60	3	10	
BF161			V _{CBO} : 50 V	Tj : 175 °C	β : 5,5	3	10	100
D. 101	TO - 72		I _C : 20 mA	R _{thc} : 580 °C/W	G _{UM} : 12 dB f _T : 350 MHz	1,5	24	800
					L 30	4		
	NPN	Ampl. RF - FI e	V _{CEO} : 40 V	P : 0,2 W T _j : 125 °C	hFE: 70 f _T :400 MHz	4		
BF162	TO - 106	oscill.	V _{CBO} : 40 V	R _{thc} : 200 °C/W	( ) 335 m z			
-	NPN	Ampl. Fl per TV	V _{CEO} : 40 V	P : 0,2 W	hFE : 70	4	10	-
		AGC	VCBO : 40 V	Tj : 125 °C	β : 6	4	10	100
BF 163				Rthc: 200 °C/W	G _{UM} : 30 dB	4	10	40
	TO-106			<u></u>	f _τ : 400 MHz		99	
	NPN	Impiego	VCEO : 40 V	P : 175 mW	hFE : 50	2,5	12 12	100
BF 166		generale RF	V _{CBO} : 40 V	Tj: 175 °C	β : 5 G 18 d8	2,5 3	10	200
	TO - 72			R _{thc} : 580 °C/W	G _{UM} : 18 dB f _T : 300 MHz	3		200
	NPN	Ampl. ftF - FI	V _{CEO} : 30 V	P : 0,13 W	hpg : 57	4	10	
BF167	19114	per TV	VCBO : 40 V	Ta : 45 °C	yfe : 105 mS	4	10	35
BF 10/	TO 707	stadio controllato	IÇ ; 25 mA	Tj : 175 °C	G _{UM} : 42 dB	4	10 10	35
	TQ - 72R			R _{thc} : 650 °C/W	f _T : 350 MHz	7		

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T _a = 25 °C)	ымі	CARATTERISTICHE a (Ta = 25 °C)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz
	NPN	Preampl, video TV	V _{CEO} : 30 V	P ± 0.3 W	β : 200 - 500	2	5	
BF169		,	VCBO : 50 V	T _i : 175 °C	1 _T : 250 MHz	2	5.	
	TO - 18		IC : 50 mA	R _{thc} : 200 °C/W				
BF169R	NPN RQ - 110		Impiego e dati tecr	nici come BF169 eccet T _j : 125 ⁰ C	; 07			
	NPN	Preampl, video TV	V _{CEO} : 30 V	P : 175 mW	hee: 90-330	1	10	
BF169A			VCBO : 30 V	Ti : 175 °C	f _T : 250 MHz	1	10	
	TO - 72R		IC : 30 mA	R _{the} : 500 °C/W	,			
	NPN	Preampl. video TV	V _{CEO} : 30 V	P : 0,3 W	hFE:>90	1	10	
BF169RA			VCBO : 30 V	Tj : 125 °C	f _T 250 MHz	1	10	
	RO - 110R		IC : 30 mA	a I was seen and	or			
	NPN	Ampl, uscita FI	V _{CEO} : 25 V	P : 0,26 W	hFE : 88	7	10	
		video TV	VCBO : 40 V	Ta : 45 °C	v _{fe} : 145 mS	7	10	35
BF173			Ic : 25 mA	aletta n. 2	G _{UM} : 42,5 dB	7	10	35
				T; : 175 °C	f _T : 550 MHz	5	10	
	TO - 72R			R _{tha} : 0,65 °C				
	NPN	Ampl. finale video	V _{CEO} : 150 V	P : 0,8 W	hFE : 70	10	50	
BF 174		32	VCBO : 150 V	T _j : 200 °C	β : 4	10	50	20
	TO - 39		IC : 0,1 A	R _{thc} : 58 °C/W				
30 (0)	NPN	Ampl. Fl per TV	VCEO : 40 V	P : 175 mW	hFE : 70	2,5	12	
BF 175		AGC	VCBO : 40 V	T _f 175 °C	β : 5	2,5	12	100
	TO - 72			R _{thc} : 583 °C/W	G _{UM} : 30 dB	4	12	40
	NPN	Ampl. FI per TV	V _{CEO} : 40 V	P : 0,25 W	hFE : 65	10	10	
BF176			VCBO : 40 V	Tj : 125 °C	β : 4,5	10	10	100
	TO - 105			R _{thc} : 200 °C/W	G ^{UM} : 30 dB	10	10	
	NPN	Ampl. finale	VCEO : 60 V	P : 0,6 W	hFE:>20	15	10	
BF177		video TV	VCBQ : 100 V	T _a 65 °C	f _T : 120 MHz	10	10	10
DI 177	TO-5		IC : 50 mA	Tj : 200 °C				
	TO - 39			R _{thc} : 45 °C/W				
	NPN		5 8	nici come BF177 eccet	to:			
BF178	TO - 5		V _{CEO} : 110 V					
	TO - 39		V _{CBO} : 160 V		(*)			
	NPN		Impiego e dati teci	nici come BF177 eccet	to:			
BF178T				P : 0,5 W				
	TO-5			T _a : 65 °C			2	
	TO - 39	١		R _{thc} : 75 °C/W	,		<u>-</u>	
	NPN			nici come BF177 eccet	to:			
BF179	TO-5		VCEO : 115 V					
	TO - 39		V _{CBO} : 250 V					
	NPN	Ampl. finale	VCEO : 115 V	P : 1,7 W	hFE:>20	20	15	
BF179A		video TV colore	VCBO : 160 V	T _c : 125 °C	f _T : 120 MHz	10	10	
	TO-5		IC : 50 mA	Tj : 200 °C				
	TO - 39			R _{tha} : 220 °C/W				

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE a (T _a = 25 °C)			f (MHz)
3F179B	NPN TO -5 TO -39		Impiego e dati tecnici come BF179 eccetto VCBO : 220 V				
BF179C	NPN TO - 5 TO - 39		Impiego e dati tecnici come BF179 eccetta VCBO : 250 V P : 0,6 W	:			
BF 180	NPN TO · 72	Ampl. RF UHF - VHF	V _{CEO} : 20 V P: 150 mW V _{CBO} : 30 V T _j : 175 °C I _C : 20 mA	hFE : 45 G _{UM} : 12 dB f _T : 675 MHz	2 2 2	10 10 10	900
BF181	NPN TO - 72	Oscill, conv. UHF	Dati tecnici come BF180 eccetto:	hFE : 29 GUM : 11 dB fT : 600 MHz	2 2 2	10 10 10	900
BF 182	NPN TO -72	Oscill, conv. VHF - UHF	VCEO : 20 V P : 150 mW VCBO : 25 V T ₁ : 175 °C I _C : 15 mA	hFE : 20 dB Yfb : 18 mS G _{UM} : 11 dB f _T : 650 MHz	2 2 2 2	10 10 10 10	900 900
BF183	NPN TO -72		Impiego e dati tecnici come BF182 eccetto	0: hFE : 25 G _{UM} : 13 dB f _T : 800 MHz	3 3 3	10 10 10	900
BF 184	NPN TO - 72R	Ampl. RF - FI per AM - FM	V _{CEO} : 20 V P: 145 mW V _{CBO} : 30 V T _a : 45 °C I _C : 30 mA T _j : 175 °C	hFE: 75-750 Yte: 35 mS f _T : 300 MHz	1	10 10 10	100
BF185	NPN TO - 72R		Impiego e dati tecnici come BF184 eccetto	hFE: 34 - 140 yfe: 33 mS f _T : 220 MHz	1 1 1	10 10 10	100
BF186	NPN TO - 39	Ampl, finale di luminanza	$V_{CER}$ : 190 V P : 2,75 W (ReE : ≤ 1 kΩ) T _C : 145 °C VCBO : 190 V T _j : 200 °C I _C : 60 mA R _{thal} : 200 °C/W	hFE : >20 f _T : 120 MHz	40 10	20 10	
BF194		Ampl. RF - FI oscill. per AM - FM	VCEQ : 20 V P : 0,22 W VCBQ : 30 V T _j : 125 °C IC : 30 mA	hFE : 115 Vfe : 35 mS fT : 260 MHz	) 1 1	10 10 10	35
BF 195	NPN MM-12R SOT-25R		Impiego e dati tecnici come BF194 eccetto	o: hFE : 67 Y _{fe} : 31 mS f _T : 200 MHz	1 1	10 10 10	100
BF196	MM-12R SOT-25R	Ampl. FI - TV CAG	VCEO : 30 V P : 0,25 W VCBO : 40 V T _j : 125 °C IC : 25 mA	h _{FE} : >20 Y _{fe} : 100 mS G _{UM} : 39 d8 f _T : 400 MHz	6 4 4 4	10	45 45
BF197	NPN MM-12R SOT-25R	Ampl, uscita FI video TV	VCEO : 25 V P : 0,25 W VCBO : 40 V T _j : 125 °C IC : 25 mA	hFE :>38 Vfe : 155 mS G _{UM} : 41 dB f _T : 550 MHz	7 7 7 6	10 10	45 45

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS: (T ₃ = 25 °C)		CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)			f (MHz
BF198	NPN TO - 92R MM - 11R		Impiego e dati tec	uci come BF196				
BF 199	NPN TO-92R MM-11R		Impiego e dati tec	nici come BF197				
BF200	NPN TO - 72	Ampl, VHF	VCEO : 20 V VCBO : 30 V FC : 20 mA	P : 0,15 W T _j : 175 °C	hFE : 30 Yfe : 56 mS GUM : 22 dB !T : 650 MHz	3 2 3 3	10 10 10	100 200
BF206	NPN TO -72	Oscill, conv. UHF	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 30 V I _C : 20 mA	P : 0,2 W T _j : 175 °C R _{thc} : 400 °C/W	hFE : 70 Gp : 20 dB 1 _T : 500 MHz	2 2 2	10 10 10	200
BF207	NPN TO - 72R	Ampl. FI video TV stadio controllato	V _{CEO} : 30 V V _{CBO} : 40 V I _C : 25 mA	P : 0,15 W T _i : 175 °C	hFE : 80 Yfe : 95 mS GUM : 42 dB 1 _T : 400 MHz	4 4 4 4	10 10 10	36,6 36,6
BF207R	NPN RO - 110R		Impiego e dati teo	nici come BF207 ecceti	to:			
BF208	NPN TO - 72R	Ampl. Fl video TV	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 40 V I _C : 25 mA	P : 0,23 W T _j : 175 °C	hFE : 100 y _{fe} : 145 mS G _{UM} : 43 dB f _T : 600 MHz	7 7 7 7	10 10 10	36,6 36,6
BF208R	NPN RO - 110R	1	Impiego e dati tec	nici come BF208 ecceti P : 0,3 W	to			
BF212	NPN TO - 72	Ampl. RF per UHF	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 30 V I _C : 20 mA	P : 0,2 W T _j : 175 °C	ήFE : 80 f√ : 600 MHz	2	10	
BF213	NPN TO - 72	Conv. UHF	Dati tecnici come	BF212 eccetto:	hFE : 50 f _T : 550 MHz	2	10 10	
BF214	NPN TO - 72R	Oscill, conv. per OM - OC Ampl. FI per AM - FM	V _{CEO} : 30 V V _{CBO} : 30 V I _C : 30 mA	P : 165 mW T _j : 175 °C R _{thc} : 500 °C/W	hFE : 90-330 Yfe : 35 mS fT : 250 MHz	1 1 1	10 10 10	10,7
BF215	NPN TO - 72R	Preampl. RF oscill, conv. per FM	Dati tecnici come	BF214 eccetto:	hFE: 40-165 Vfb: 33 mS	1	10 10	100
BF222	NPN TO - 72	Ampl. RF conv. FM	VCEO : 50 V VCBO : 50 V IC : 20 mA	P : 175 mW T _j : 175 °C R _{thc} : 577 °C/W	hFE : 60 β : 4 G _{UM} : 20 dB	2 2 4	7 7 5	100 100
BF223	NPN SOT-25R MM-12R	Ampl. FI per TV colore	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 35 V I _C : 40 mA	P : 0,35 W T _j : 140 °C R _{thc} : 230 °C/W	hFE : >40 v _{fe} : 200 mS f _T : 760 MHz	15 7 5	10 10 10	36

SIGLA	TIPO é CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS			TTER a = 25	ISTICHE a			f (MHz
	NPN	Ampl. FI	V _{CEO} : 25 V	P : 50 mW		hfE	100	3	10	
BF227		video TV	VCBO : 40 V	Ta: 45 °C			: 80 mS	3	10	36
	TOM-23R		IC : 25 mA	Tj : 125 °C			: 600 MHz	3	10	
	NPN	Ampl. pilota	V _{CEO} : 80 V	P : 50 mW			: >30	2	10	
BF228	TOM - 23	per nixie	VCBO : 7 V IC : 50 mA	T _a : 45 °C T _j : 125 °C		ÍΤ	: >50	10	10	
	NPN		Impiego e dati teo	nici come 8F194 eccet	to:			10.		
BF229				P : 50 mW						
	TOM - 23R			Ta : 45 °C						
	NPN		Impiego e dati tec	nici come BF195 eccet	to:					
BF230	TOM 220			P:50 mW Ta:45 °C						
	TOM - 23R			18.45 %			_			
	NPN	Ampl. FI	V _{CEO} : 25 V	P 0,23 W			: >30	7	10	
8F232	TO - 72R	video TV	V _{CBO} : 48 V I _C : 30 mA	Tj : 175 °C R _{thc} : 350 °C/W		¹T	: 600 MHz	10	10	
	NPN	Oscill, conv.	Vera : 20 V	P:0,3 W	2	bee.	: 40 - 70	1	10	
6	MATIN	per OM - OC	VCEQ : 30 V VCBO : 30 V	T _i : 125 °C	3		: 60 - 100	1	10	
		Ampl. FI	IC : 30 mA	.1	4		: 90 - 150	1	10	
BF233		per AM - FM	-		5	hFE	: 140 - 220	1	10	
					6		: 200 - 350	1	10	
	RO - 110R						: 33 mS : 260 MHz	1	10 10	10,7
BF234	NPN RQ - 110R		Impiego e dati teo	nici come BF233 eccet	ito:	μFE	: 90 - 330	1	10	
BF235	NPN RO - 110R	Preampl, RF oscill, conv. FM	Dati tecnici come	BF233 eccetto :		hFE	: 40 - 165	1	10	
	NPN	Ampi. RF	VCEO : 40 V	P : 225 mW	-	hFE	: 67 - 220			
BF240	TO-92R	per AM - FM	VCBO : 40 V	T; 125 °C			: 75 mS	2	10	10,7
	MM-11R		1 _C : 25 mA			17	: 430 MHz	1	10	
	NPN	Ampl. RF	V _{CEO} : 40 V	P : 225 mW			: 36 - 125			
BF241	TO-92R	per AM e	VCBO : 40 V	Tj : 125 ℃			: 75 mS	2		10,7
	MM-11R	FM-AGC	IC : 25 mA			¹T	: 400 MHz		10	
	NPN			NO ASS DEPOSITOR PROCESS						
BF254	TO - 92R		Impiego e dati ter	cnici come BF194						
	MM-11R									
	NPN									
BF255	TO - 92R MM - 11R		Impiego e dati ter	cnici come BF195						
	NPN	Ampl, finale	V _{CEO} : 160 V	P : 5 W		ptE	: >25	30	10	
BF257	5,55(0(3)	video TV	IC : 0,1 A	Tc : 25 °C		fT	: 110 MHz	30		
	TO - 39			T _j : 125 °C						

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C)		CARATTERISTICHE a		V _{CE} (V)	f (MHz
BF258	NPN TO - 39	Ampl. finale video TV	V _{CEO} : 250 V I _C : 0,1 A	P : 5 W T _C : 25 °C T _j : 125 °C	hFE:>25 1 _T :110 MHz	30 30	10	
BF259	NPN TO - 39	Ampt, finale video TV	VCEO : 300 V	P : 5 W T _C : 25 °C T _j : 125 °C	hee : >25 f _T : 110 MHz	30 30	10	
BF260	NPN TO - 72R	Preampl. VHF CAG	VCBO : 45 V IC : 50 mA	P : 0,15 W T _j : 175 °C	hFE: 70 f _T : 800 MHz	1	6	
BF261	NPN TO - 72R	Ampl. FI CAG	Đati tecnici come V _{CBO} : 40 V	8F26Q eccetto:	f _T : 730 MHz			
BF270	NPN TO - 72R	Ampl. El per TV stadio controllato	VCEO : 40 V VCBO : 40 V IC : 20 mA	P : 0,150 W T _j : 175 °C R _{thc} : 750 °C/W	hfg:45 β:6	3,5 3,5	10 10	100
BF271	NPN TO - 72R	Ampl. FI-TV	VCEO : 40 V VCBO : 40 V IC : 30 mA	P : 0,24 W Tj : 175 °C Rthc : 375 °C/W	hee: 75 β : 10	10 10	15 15	100
BF287	NPN TO - 72A	Oscill, conv. per AM Ampl. FI per AM - FM	VCEO : 40 V VCBO : 40 V IC : 20 mA	P : 0,150 W Tj : 175 °C Rthc : 750 °C/W	hee:50 β : 6	1	7	100
BF 288	NPN TO-72A	Àmpl. FI per AM - FM stadio controllato	Dati tecnici come	BF287 eccetto:	hfE:90 β : 5	1 1	7	100
BF290	NPN TO-72R	Oscill, conv. UHF	Dati tecnici come	BF287 eccetto:	hFE : 60 β : 9	3 3	10 10	100
BF291	NPN TO - 18	Pilota video Elaboratore di segnali di colore	VCEO : 40 V VCBO : 50 V 4C : 0,1 A	P : 0,36 W T _j : 200 °C R _{thc} : 146 °C/W	A heε: 105 B heε: 170 β : 3,8 t _{on} : 28 t _{off} : 237 os	2 2 10 50 50	10 10 10 30 30	100
BF292A	NPN TO - 5 TO - 39	Uscita video alta tensione	V _{CEO} : 150 V V _{CBO} : 150 V I _C : 0,1 A	P : 0,8 W T _j : 200 °C R _{thc} : 35 °C/W	hFE: 70 β : 3,3	10 10	50 50	20
BF292B	NPN TO - 5 TO - 39		Impiego e dati ted VCEO : 190 V VCBO : 190 V	inici come 8F292A eccet	to:			
BF292C	NPN TO - 5 TO - 39		Impiego e dati ted VCEO : 220 V VCBO : 220 V	mici come BF292A eccet	to:			
BF302	NPN TO - 72R	Ampl. FI per AM - FM	V _{CBO} : 40 V I _C : 50 mA	P : 0,15 W T _j : 175 °C	hFE: 35-125 t _T :650	1	6	

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T _a = 25 °C)		CARATTERISTICHE a (T _a = 25 °C)			f (MHz
BF303	NPN TO-72R	Ampl. FI per AM	V _{CBO} : 40 V I _C : 50 mA	P : 0,15 W T _j : 175 °C	hpe : 110 - 220 f _T : 500 MHz	1	6	
BF304	NPN TO - 72R	Ampl. RF per VHF	V _{CBO} : 40 V I _C : 50 mA	P : 0,15 W T _j : 175 °C	hFE: 35 - 120 f _T : 500 MHz	i	6	
BF305	NPN TO - 39	Ampl. finale video TV	VCBO : 185 V IC : 0,1 A	P : 0,6 W T _a : 65 °C T _j : 200 °C	hFE: 20 f _T :100 MHz			
BF306	NPN TO - 72R	Ampł. Fi video TV	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 40 V I _C : 25 mA	P : 0,175 mW T _j : 175 °C	hFE: 37 f _T :1000 MHz	7	10	
BF310	NPN TO -92	Ampl. Fl - TV	V _{CEO} : 30 V I _C : 25 mA	P : 0,24 W T _a : 45 °C	hFE:>28 y _{fe} :>80 mS i _T :<580 MHz	4 4 1		
BF311	NPN TO -92R	Ampl. Fi - TV	VCEO : 25 V IC : 40 mA	P : 0,28 W Ta : 45 °C	hFE : >40 Yfe : >155 mS f _{T .} : 750 MHz	15 7 5		
BF314	NPN TO - 92	Ampl. conv. per VHF	VCEO : 30 V IC : 25 mA	P : 0,24 W T _a : 45 °C	hFE:>28 Vie::36 mS fT::<580 MHz	4 1 1	10 10 10	
BF329	NPN SOT - 25R		Impiego e dati teo	nici came BF196				
BF330	NPN SOT - 25R	v	Impiego e dati teo	nici come BF197				
BF332	NPN SOT - 25 R	Conv. oscill. AM	VCBO : 30 V IC : 30 mA	P:0,25 W Tj:125 °C	hFE: 65 - 220 fT: 600 MHz	1	10	
BF333	NPN SOT - 25R	Ampl. FI	Dati tecnici come	BF332 eccetto:	bFE: 35 - 120 f _T : 400 MHz	1	10	
BF334	NPN SOT-25R	Ampl. Fi per AM - FM	V _{CEO} : 30 V V _{CBO} : 40 V 1 _C : 25 mA	P : 0,25 W T _j : 125 °C	hFE: 65-220 Vfe: 36 mS fT: 430 MHz	1 1	10 10 10	10,7
BF335	NPN SOT - 25 R		Impiego e dati tec	nici come BF334 eccetti	o: hfe : 35 - 125 f _T : 370 MHz	1	10 10	
BF336	NPN TO - 39	Ampl, finale video TV	VCEO : 180 V VCBO : 185 V IC : 0,1 A	P : 3 W T _C : 140 °C T _j : 200 °C R _{tha} : 220 °C/W	hFE:>20 fT:>80 MHz	30 30	10 20	
BF337	NPN TO - 39	<u></u>	Impiego e dati teo VCEO : 200 V VCBO : 250 V	nicí come BF336 eccetto	D:		*	

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	4MI	CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)	MA)	V _{CE} (V)
DE 220	NPN		impiego e dati tecn	:			
BF338	TÓ - 39		V _{CEO} : 225 V V _{CBO} : 300 V				
	NPN	Ampl. RF - FI	V _{CEO} : 30 V	P : 0,15 W	hFE: 90 - 220	1	10
9F344	TO - 18R		IC : 50 mA	т _ј : 175 °С	f _T : 500 MHz	5)	
BF345	NPN TO - 18R		Impiego e dati tecn	ici come BF344 eccetto	: h _{FE} : 40 - 115	1	10
	NPN	Ampl. uscita	VCBO : 310 V	P : 0,6 W	hFE: 20		
BF390	TO - 39	TV colore	IC : 0,1 A	T _a : 65 °C T _i : 175 °C	† _T : 120 MHz		
	NPN	Ampl. RF	V _{CEQ} : 20 V	W E,O : 9	hFE : >35	10	10
BFY37	TO - 18	Oscill, VHF	V _{CBO} : 25 V I _C : 0,1 A	Tj : 175 °C R _{tho} : 150 °C/W	f _T :>200 MHz	10	10
	NPN	Ampl. RF	V _{CEO} : 25 V	P : 0,3 W	1 hpg: 35 - 110	10	10
	****	Oscill, VHF	VCBO : 45 V	T _i : 175 °C	2 hFE: 100 - 200	10	10
BFY39			IC : 0,1 A	R _{thc} : 150 °C/W	3 hFE: 180 - 400	10	10
	TO-18				$\beta$ : 180 - 400 f _T : 150 MHz	1 10	10 10
	NPN	Ampt. finale	VCER : 120 V	P : 0,8 W T _i : 200 °C	hFE : >35	50	10
BFY41		videa TV	(R _{BE} : < 250 Ω) V _{CBO} : 120 V	R _{thc} : 58 °C/W			
	TO - 39		IC : 0.6 A				
	NPN	Ampl. finale	V _{CEO} : 140 V	P : 0,8 W	hFE: >25	10	10
BFY43	5	video TV	VCBO : 140 V	T _i : 175 °C	f _T : 60 MHz	10	10
	TO - 39		I _C : 0,1 A				
	NPN	Impiego generale	V _{CEO} : 35 V	P : 0,8 W	hFE: 55	150	6
BFY50	TQ-5	Commutazione	VCBO : 80 V	Tj : 200 °C	β : 45	10	6
	TO - 39		IC : 1 A	R _{thc} 1 35 °C/W	f _T : 100 MHz	50	6
	NPN	Impiego generale	V _{CEO} : 30 V	P : 0,8 W	hFE: 70	150	6
BFY51	TO-5	Commutazione	VCBO : 60 V	T _i : 200 °C	$\beta$ : 60	10	6
	TO - 39		IC : 1 A	R _{thc} : 35 °C/W	f _T : 110 MHz	50	6
	NPN	Impiego generale	VCEO : 20 V	P : 0,8 W	NFE: 130	150	6
BF <b>Y</b> 52	TO - 5	Commutazione	VCBO : 40 V	Tj : 200 °C	β : 120	10	6
	TO - 39		Ic : 1 A	R _{thc} : 35 °C/W	f _T : 120 MHz	50	, <u>-</u>
	NPN	Ampl. RF	VCEO : 32 V	P : 0,3 W	hFE : >35	50	5
BSX24		Oscill, VHF	V _{CBO} : 32 V	Tj : 175 °C	f _T : 200 MHz	10	10 10
JUNES	TO - 18	Commutazione	IC : 0,1 A	Rthc : 150 °C/W	t _{an} : 25 ns t _{aff} : 400 ns	10 10	10
			AF 17	P . 0.2 W	h 50	1	10
	NPN	Oscill, conv.	VCEO : 25 V VCBO : 60 V	P : 0,8 W T _i : 200 °C	$\beta = 30 - 100$	i	5
BSY51	TO - 39	per OM - OC Commutazione	IC : 0.5 A	R _{thc} : 58 °C/W	fT 100 MHz	50	10

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a IC (mA)	VcE (V)
	NPN		Impiego e dati tecnici come BSY51 eccetto		1	10
BSY52	TO - 39		,	$eta$ : 50 - 200 f $_{T}$ : 130 MHz	1 · 50	5 10
BU1 <b>00</b>	NPN	Ampl. finale orizz. TV	V _{CEO} : 60 V P: 15 W V _{CBO} : 150 V T _C : 75 °C	hRE : 100	500	10
	TO - 3A		1C : 10 A T _j : 150 °C		¥	
BU1 <b>02</b>	NPN	Ampl. finale orizz. TV	V _{CEO} : 150 V P : 25 W V _{CBO} : 400 V T _c : 100 °C	hFE: 110 t _{on} : 0,66 μs	1000	6
	TO-3A		IC : 7 A T _j : 150 °C	t _{off} : 1,1 μs		
BU103	NPN	Finale vert. TV	VCER: 120 V P: 30 W (RBE: 220 Ω) T _C : 25 °C	hfe: 50-200 f _T : 100 MHz	200 100	10 10
	TO - 66	<b>*</b>	VC8O : 120 V τ _j : 175 °C			
BU104	NPN	Finale orizz. TV	V _{CEX} : 400 V P: 85 W V _{CBO} : 400 V T _C : 25 °C	hFE: 10-50 f _T : 10 MHz*	5000 500	3,5 10
	TO-3		IC : 7 A Tj : 200 °C			
BU105	NPN	Defless, orizz, TV	V _{CER} :750 V P : 10 W (R _{BE} :≤100 Ω) T _C : 90 °C	hFE: 8 f _T : 7,5 MHz	800 100	5 5
BO 100	TO-3		V _{CBO} : 750 V T _j : 115 °C I _C : 2,5 A	<u> </u>		
BU108	NPN	Defless. orizz. TV colore	$V_{CER}$ : 750 $V$	hFE:4 f _T :7 MHz	4000 100	5 5
	TO-3		tc : 5 A			
BU109	NPN		Impiego e dati tecnici come BU104 eccetto VCEX : 330 V	ī		
	TO-3		V _{CBO} : 330 V	han : >7	6000	
BU112	NPN TO-3	Finale orizz. TV colore	V _{CEX} : 550 V P : 85 W V _{CBO} : 550 V T _C : 25 °C I _C : 10 A T _j : 200 °C	hFE : >7	0000	_
BU113	NPN TO-3		Impiego e dati tecnici come BU112 eccetto VCEX : 700 V			
BU115	NPN	Defless, orizz. TV colore	V _{CER} : 600 V P : 50 W (R _{BE} : ≤10 Ω) T _C : 75 °C	hFE: 20 - 100	5000	5
	TO-3		VCBO: 800 V T _j : 150 °C IC: 15 A			
BU116	NPN	Commutazione	Dati tecnici come BU115 eccetto: VCER : 300 V			
BU 1 16	TO-3	1991	V _{CBO} : 400 V	· -		
BU117	NPN	Ampl. pilota orizz. TV colore	Dati tecnici come BU115 eccetto: VCER : 200 V			
~~11/	TO-3	VILLE, 1 4 COLUMN	V _{CBO} : 250 V		-	
BU120	NPN .	Chopper TV	VCEO : 250 V P : 50 W VCBO : 400 V T _C : 75 °C	hFE: 35 - 165	1000	6
20.20	TQ-3		IC : 5 A Tj : 150 °C	•		

NPN   Ampl. finate   VCEO : 200 V   P : 50 mW   hre : >7   6000   5	GLA	TIPO CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T _a = 25 °C)	SIMI		TTERISTICHE = 25 °C)	a (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz
NPN		NPN	Ampl. finale					6000	5	
NPN	121		orizz. TV				f _T : 6 MHz			
BU122		TO - 3		I _C : 10 A	т _ј : 150 °С					
NPN		NPN	Ampl. finale	VCEO : 150 V	P : 50 W		hFE: 26 - 250	1000	5	
NPN	1122		vert, TV	VCBO : 250 V	T _C : 75 °C		iT : 10 MHz			
BU123		TQ - 3		IC : 5 A	Т _ј : 150 °С				1	
August		NPN	Ampl. finale BF	VCEO : 120 V	P : 50 W		hFE: 25 - 250	1000	5	
NPN	1123									
BU126   TO - 3		TO-3	Commutazione	IC : 5 A	Tj : 150 °C			-		
Set 126		NPN	Defless orizz TV	VCEO : 300 V	P : 30 W		f _T : 8 MHz	200	10	
NPN	1126	131.14	Delless. Olizz. 1 v				20 20 2			
BU129		TQ-3								
BU129		NDN	Ampl. finals	Vary : 400 V	P · 25 W		hec:>20	3000	1.5	
TO -3   Tj : 150 °C	1420	MEIN							17.	
SFT162   generali AF   VCBO : 70 V   T _j : 100 °C   F _T : >70 MHz   6   12	7128	TO-3	01122. TV		Tj : 150 °C					
SFT162   generali AF   VCBO : 70 V   Tj : 100 °C   FT : >70 MHz   6   12	_	DAID	Impleshi	Vere 70 V	P 0.15 W		8 : 50 - 600	6	12	
TO-1   alta tentione   IC   : 10 mA   Rithc   : 300 °C/W	T462	FINE								
Nearly Note	1 102	TO-1		And the second second	R _{the} : 300 °C/W		., .,	-		
VCBO : 32 V   T _j : 100 °C   T _T : 140 MHz   4   9	VX.	DA (D	B 1 14 TM	V 116 V	D - 0.15 W		R → 200	4	9	
TO-1    C   : : 10 mA   R _{thc} : : 300 °C/W		PINE	Preampl, video 1 v				-	4		
SFT211   di potenza   (RgE : 220 Ω)   T _C : 25 °C   Y   hFE : 30 - 70   2000   2   VCBO : 80 V   T _j : 95 °C   X   hFE : 50 - 100   2000   2   I _C : 6 A   I _T : 0.5 MHz   500   14	1 163	TO - 1			Rthe : 300 °C/W		1			
SFT211   di potenza   (RgE : 220 Ω)   T _C : 25 °C   Y   hFE : 30 - 70   2000   2   VCBO : 80 V   T _j : 95 °C   X   hFE : 50 - 100   2000   2   I _C : 6 A   I _T : 0.5 MHz   500   14			Amel PE	Voca : 80 V	P : 45 W		hee : >15	6000	,	
VCBO : 80 V T _j : 95 °C		rive				Y		2000	2	
IC : 6 A   Fg : 8 kHz   500   14	T911		th potenza					2000	2	
TO-3	1211				.,			500	14	
SFT213		TO-3						500	14	
SFT213		DAID	Ampl RF	Vc=p: 40 V	P : 45 W		hee : >20	3000	2	
VCBO : 40 V   T _j : 95 °C   X   hFE : 50 - 100   2000   2   10   3 A		EWE				Υ		2000	2	
TO-3   IC : 3 A   β : 50   1000   5	T213		di potenza			х	hFE: 50 - 100	2000	2	
PNP					•					
SFT214   Ampl. 8F   C   3 A   T _C   25 °C   Z   hFE   20 - 40   2000   2   2   2   2   2   2   2   2		TO - 3					fβ : 8 kHz	500	14	
di potenza   IC   : 3 A   T _C   :25 °C   Z   hFE   : 20 - 40   2000   2		PNP	Amol. BF	VCBO : 60 V	P : 45 W		hFE:>15	3000		
SFT214   Circuiti elim.   T _j : 95 °C   Y hFE : 30 - 70   2000   2   X hFE : 50 - 100   2000   2   Y hFE : 50 - 100   2   Y hFE : 50 - 100   2   Y hFE : 50 - 100   1   4   Y hFE : 50 - 100			man promise Activities	IC : 3 A	T _C : 25 °C	Z				
TO -3   To			Circuiti alim.	2.5	T _j : 95 °C					
TO -3    To -3	FT214					х				
SFT250   PNP   Implego e dati tecnici come SFT214 eccetto:     VCBO : 80 V     VCBO : 80 V     FNP   Ampl. FI   VCBO : 16 V   P : 0.185 W   β : 50   1 6   6   FN										
SFT300         TO-3         VCBO : 80 V           SFT306         PNP Ampl. FI VCBO : 16 V P : 0,185 W β : 50 1 6           per AM         VCBO : 24 V T _j : 100 °C Y _{fg} : 17 · 21 mS 1 6         1 6           TO-1         IC : 10 mA Rthc : 200 °C/W f _T : 5 MHz 1 6           PNP         Implego e dati tecnici come SFT306 eccetto: β : 75 1 6         1 6           SFT307         Implego e dati tecnici come SFT306 eccetto: β : 75 1 6         1 6           SFT307         Signillo Y _{fg} : 22 - 28 mS 1 6		TO - 3					f _T : 0,5 MHz	.500	14	
PNP   Ampl. FI   VCEO : 16 V   P : 0,185 W   β : 50   1   6	ET 260				mici come SFT214 eccet	to:				
SFT306         PNP         Ampl. FI         VCEO : 16 V         C : 100 °C         Yfe: 17 · 21 mS         1 6           TO-1         IC : 10 mA         Rthc : 200 °C/W         fT : 5 MHz         1 6           PNP         Implego e dati tecnici come SFT306 eccetto:         β : 75         1 6           bianco         yfe: 19 · 24 mS         1 6           spiallo         yfe: 22 - 28 mS         1 6	1200	TO-3		VC80 : 80 V			_		_	
TO-1 IC : 10 mA Rthc : 200 °C/W fT : 5 MHz 1 6  PNP Implego e dati tecnici come SFT306 eccetto: β : 75 1 6  bianco y _{fe} : 19 - 24 mS 1 6  sFT307 giallo y _{fe} : 22 - 28 mS 1 6		PNP								2
PNP Implego e dati tecnici come SFT306 ecostto: β : 75 1 6 biance y _{fe} : 19 - 24 mS 1 6 giallo y _{fe} : 22 - 28 mS 1 6	FT306	TO-1	per AM		T _j : 100 °C R _{the} : 200 °C/W		fr: 5 MHz	i		٠
bianco   y _{fe} : 19 - 24 mS   1   6     SFT307   giallo   y _{fe} : 22 - 28 mS   1   6		-	-						6	
<b>8FT307</b> giallo y _{1e} : 22-28 mS 1 6		PNP		Impiego e dati teo	nici come SF1306 eccel		E			2
many 146 er so (1)	FT307						vs_: 22 - 28 mS			2
TO-1 f _T : 7 MHz 1 6	- Powerowskii	TO - 1				310110	fr : 7 MHz	1		

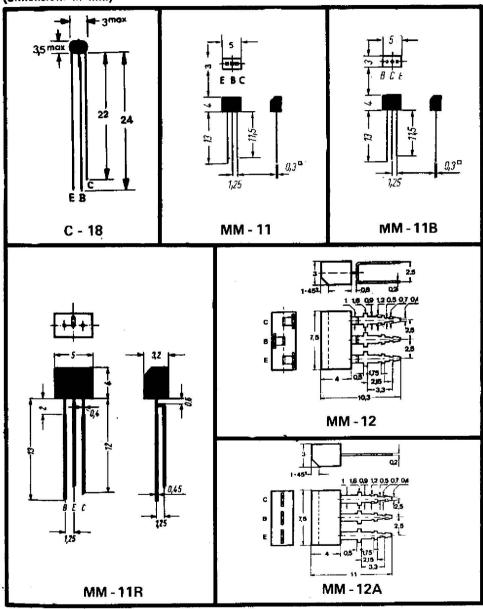
PNP SFT316 TO - 1 PNP SFT316 TO - 7; SFT317 TO - 1 SFT320 PNP TO - 1 PNP SFT321 TO - 1 PNP SFT322 TO - 1 PNP SFT323 TO - 1 PNP SFT323 TO - 1 PNP	Conv. AM Ampl. Fl per A	VCEO : 16 V P : 0,15 W VCBO : 32 V T _j : 100 °C IC : 10 mA Rthc : 300 °C/W  Dati tecnici come SFT316 eccetto:  M Dati tecnici come SFT316 eccetto:  Dati tecnici come SFT316 eccetto:	bianco giallo viola blu verde blu	$\begin{array}{lll} \beta & : 100 \\ y_{1e} : 26 - 30 \text{ mS} \\ y_{1e} : > 28 \text{ mS} \\ T : 9 \text{ MHz} \\ \\ \beta & : 100 \\ \beta : 150 \\ y_{1e} : 20 \text{ mS} \\ T : 70 \text{ MHz} \\ \\ \beta & : 150 \\ y_{fe} : 15 \text{ mS} \\ T : 60 \text{ MHz} \\ \\ \beta & : 150 \\ \\ \beta : 150 \\ \end{array}$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 2 50
PNP SFT316 TO - 7; PNP SFT317 TO - 1 SFT319 PNP TO - 1 PNP SFT320 TO - 1 PNP SFT321 TO - 1 PNP SFT322 TO - 1 PNP SFT323 TO - 1	per AM - FM conv. AM  Conv. AM  Ampl. FI per A  Oscill. conv. per OM - OC	VCBQ : 32 V T _j : 100 °C t _C : 10 mA R _{thc} : 300 °C/W  Dati tecnici come SFT316 eccetto:  M Dati tecnici come SFT316 eccetto:  Dati tecnici come SFT316 eccetto:	vio:a blu verde	$f_T$ : 9 MHz $\beta$ : 100 $\beta$ : 150 $y_{te}$ : 20 mS $f_T$ : 70 MHz $\beta$ : 15 mS $f_T$ : 60 MHz $\beta$ : 150 $\beta$ : 150	1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 6 6 6 6 6	50
SFT316  TO - 72  PNP  SFT317  TO - 1  SFT319  PNP  TO - 1  PNP  SFT321  TO - 1  PNP  SFT322  TO - 1  PNP  SFT323  TO - 1	per AM - FM conv. AM  Conv. AM  Ampl. FI per A  Oscill. conv. per OM - OC	VCBQ : 32 V T _j : 100 °C t _C : 10 mA R _{thc} : 300 °C/W  Dati tecnici come SFT316 eccetto:  M Dati tecnici come SFT316 eccetto:  Dati tecnici come SFT316 eccetto:	blu	$\beta$ : 150 Y _{fe} : 20 mS † _T : 70 MHz $\beta$ : 150 Y _{fe} : 15 mS † _T : 60 MHz $\beta$ : 150 $\beta$ : 150	1 1 1 1 1 1	6 6 6 6 6	***
TO - 72 PNP SFT317 TO - 1 SFT319 PNP TO - 1 PNP SFT321 TO - 1 PNP SFT322 TO - 1 PNP SFT323 TO - 1 PNP	Conv. AM  Conv. AM  Ampl. Fl per A  Oscill. conv. per OM - OC	IC : 10 mA R _{thc} : 300 °C/W  Dati tecnici come SFT316 eccetto:  M Dati tecnici come SFT316 eccetto:  Dati tecnici come SFT316 eccetto:	verde	$y_{fe}$ : 20 mS $f_T$ : 70 MHz $\beta$ : 150 $y_{fe}$ : 15 mS $f_T$ : 60 MHz $\beta$ : 150 $\beta$ : 150 $\beta$ : 150 $\beta$ : 150	1 1 1 1 1	6 6 6 6	***
TO - 72 PNP SFT317 TO - 1 SFT319 PNP TO - 1 PNP SFT321 TO - 1 PNP SFT322 TO - 1 PNP SFT323 TO - 1 PNP	Conv. AM  Ampl. Fl per A  Oscill. conv. per OM - OC	Dati tecnici come SFT316 eccetto:  M Dati tecnici come SFT316 eccetto:  Dati tecnici come SFT316 eccetto:		$f_{T}$ : 70 MHz $\beta$ : 150 $y_{fe}$ : 15 mS $f_{T}$ : 60 MHz $\beta$ : 70 $\beta$ : 150	1 1 1	6 6 6	***
SFT317 TO-1  SFT319 PNP TO-1  SFT320 PNP SFT321 TO-1 PNP  SFT322 TO-1 PNP  SFT323 TO-1 PNP	Ampl. Fl per A Oscill. conv. per OM - OC	M Dati tecnici come SFT316 eccetto:  Dati tecnici come SFT316 eccetto:		$y_{fe}$ : 15 mS $f_{T}$ : 60 MHz $\beta$ : 70 $\beta$ : 150	1	6	50
TO-1  SFT319 PNP TO-1  SFT320 PNP TO-1  PNP  SFT321 TO-1  PNP  SFT322 TO-1  PNP  SFT323 TO-1  PNP	Oscill, conv. per OM - OC	Dati tecnici come SFT316 eccetto:		f _T : 60 MHz β: 70 β: 150	1	6	50
SFT319 PNP TO - 1  SFT320 TO - 1  PNP  SFT321 TO - 1  PNP  SFT322 TO - 1  PNP  SFT323 TO - 1  PNP  SFT337 TO - 1	Oscill, conv. per OM - OC	Dati tecnici come SFT316 eccetto:		β : 70 β : 150 β : 150	1	6	
SFT319 TO -1  SFT320 PNP TO -1  PNP  SFT321 TO -1  PNP  SFT322 TO -1  PNP  SFT323 TO -1  PNP  SFT323 TO -1	Oscill, conv. per OM - OC	Dati tecnici come SFT316 eccetto:		β : 150 β : 150			
SFT320 PNP TO-1 PNP SFT321 TO-1 PNP SFT322 TO-1 PNP SFT323 TO-1 PNP SFT323	Oscill. conv. per OM - OC	<del></del>	blu	β:150	1	6	
SFT320 TO-1 PNP SFT321 TO-1 PNP SFT322 TO-1 PNP SFT323 TO-1 PNP SFT323	per OM - OC	<del></del>				7-47	
PNP SFT321 TO - 1 PNP SFT322 TO - 1 PNP SFT323 TO - 1 PNP SFT337 TO - 1		<del>-</del> ,			1	6	
SFT321  TO - 1  PNP  SFT322  TO - 1  PNP  SFT323  TO - 1  PNP  SFT337	Ampl. finale BF			f _T : 60 MHz	1	6	
TO - 1  PNP  SFT322  TO - 1  PNP  SFT323  TO - 1  PNP  SFT337				hFE : 20 - 40	100	1	
TQ - 1 PNP SFT322 TO - 1 PNP SFT323 TO - 1 PNP SFT337		V _{CBO} : 32 V T _j : 100 °C	oro	hFE : 25	100	1	
PNP SFT322 TO-1 PNP SFT323 TO-1 PNP SFT337		I _C : 0,3 A R _{thc} : 80 °C/W	arańcio	hFE: 35	100	1	
TO-1 PNP SFT323 TO-1 PNP SFT337 TO-1				fβ : 17 kHz f _T : 0,8 MHz	1	6 6	
TO-1 PNP SFT323 TO-1 PNP SFT337 TO-1					100		
TO-1 PNP SFT323 TO-1 PNP SFT337 TO-1	Ampl. finale BF		giallo	hfE: 40-60 hfE: 45	100 100	1	
TO-1 PNP SFT323 TO-1 PNP SFT337 TO-1		V _{CBO} : 32 V T _i : 100 °C I _C : 0,3 A R _{thc} : '80 °C/W	verde	h#E: 55	100	1	
PNP SFT323 TO-1 PNP SFT337 TO-1		C SAN THE STATE		fβ : 18 kHz	1	6	
TO-1 PNP SFT337 TO-1				f _T : 1,2 MHz	1	6	
TO-1 PNP SFT337 TO-1	Ampl, finale BF	VCEO : 20 V P : 0,25 V		h#E: 60 - 150	100	1	
TO-1 PNP SFT337 TO-1	compl. SFT373		blu	hFE: 67	100	1	
TO-1 PNP SFT337		IC : 0,3 A R _{thc} : 80 °C/W	viola	hFE: 90	100	1.	
PNP SFT337 TO-1		e.	bianco	hғЕ:115 fg:19 kHz	100	6	
SFT337 TO-1			*	f _T : 2,4 MHz	i	6	
SFT337	Preampt. BF	VCEO : 16 V P : 0,185 W	v	β : 50 - 100	1	6	
TO-1	basso rumore	VCBO : 24 V Ti : 100 °C		β : 75 - 150	_ 1	6	
		IC : 0,15 A Rthc : 200 °C/V	/ VII	$\beta$ : 125 - 250	1	6	
				fβ: 40 kHz f _T : 7 MHz	1	6	
PNP		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Preampl, BF	Dati tecnici come SFT337 eccetto:	verde	β: 45-160 β: 55	1	6 6	
SFT337A			blu	β : 70	1	6	
ser assistativassi			viola	β: 90	1	6	
TO-1			bianco	β : 130	1	6	
PNP		V _{CES} : 70 V P : 0,25 W		$\beta$ : > 30	1	6	
	Ampl. BF	VCBO: 70 V Tj : 100 °C	V	β :>50	1	6	
SFT343	Ampl. BF alta tensione	IC : 0,15 A Pthc : 80 °C	∧w VI	β :>75	1	6	
TO - 1	100100000000000000000000000000000000000			fβ : 18 kHz f _T : 1,2 MHz	i	6	

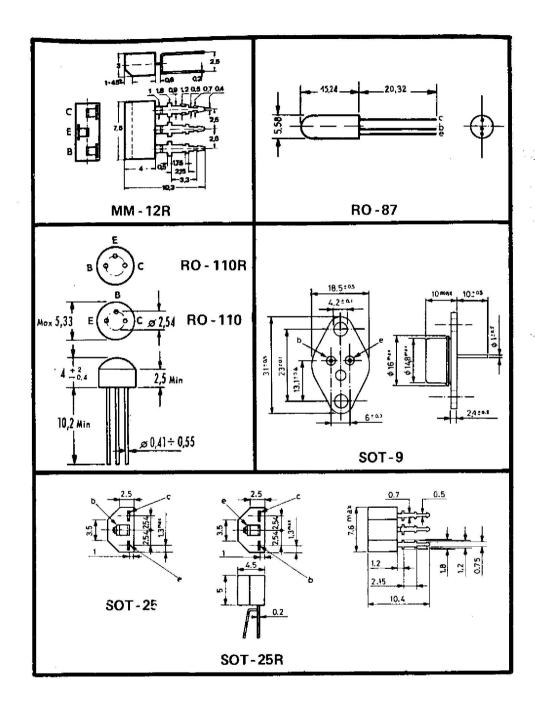
SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C			ATTERISTICHE T _e = 25 °C)	•	V _{CE} (V)	f (MH
	PNP	Preampl. e	V _{CEO} : 20 V	P : 0,25 W		β: 20-45	. 1	6	
		pilota BF	VCBO : 32 V	T _i : 100 °C	oro	β : 27	1	6	
SFT351			IC : 0,15 A	R _{thc} : 100 °C/W	arancio	β:37	1	6	
						fβ : 17 kHz	1	6	
	TO - 1					f _T :0,8 MHz	1	6	
	PNP		Impiego e dati teo	nici come SFT351 ecc	etto:	β: 35-65	1	 6	
					giallo	β : 45	1	6	
SFT352					verde	β : 55	1	6	
						fβ : 18 kHz	1	6	
	TO-1					fT : 1,2 MHz	1	6	
	PNP	Preampl, e	V _{CEO} : 20 V	P : 0,25 W		β : 55 - 250	1	6	
		pilota BF	V _{CBO} : 32 V	Ti : 100 °C	blu	β : 70	1	6	
			IC : 0,15 A	R _{thc} : 100 °C/W	viola	β : 90	1	6	
SFT353				F1.00	bianco	$\beta$ : 125	1	6	
					grigio	β : 195	1	6	
						fβ : 19 kHz	1	6	
	TO-1					f _T : 2,4 MHz	1	6	
	PNP	Oscill, conv.	V _{CEO} : 16 V	P : 0,15 W		β : 150	1	6	
SFT354		per OM - OC	V _{CBQ} : 32 V	T _i : 100 °C		Yte: 38 mS	1	6	0,5
	TO-72L		IC : 10 mA	R _{thc} : 300 °C/W		f _T : 80 MHz	1	6	
	PNP	Oscill, conv.	V _{CEO} : 16 V	P : 0,15 W		β : 150	1	6	
\$FT357		per MF	VCBQ : 32 V	T; : 100 °C		y _{ffh} : 16 mS	1	6	100
	TO-72L		IC : 10 mA	R _{the} : 300 °C/W		f _T : 90 MHz	1	6	
	PNP	Preampl. RF	V _{CEO} : 16 V	P : 0.15 W	174	β : 150	1	6	
SFT358		per MF	V _{CBO} : 32 V	Ti : 100 °C		yfta 18 mS	1	6	100
	TO - 72L		IC : 10 mA	R _{thc} : 300 °C/W		f _T : 110 MHz	1	6	
	NPN	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 6 V	P : 0,25 W	v	hFE : 50-100	100	1	
		compl. SFT323	VCBO : 12 V	Ti : 100 °C	VI	hFE : 75 - 150	100	1	
			Ic : 0,3 A	R _{thc} : 80 °C/W		hpp : 125 - 250	100	1	
SFT373					bļu	hFE : 70	100	1	
					viola	hfE : 85	100	1	
					bianco	hFE : 130	100	1	
						fβ : 35 kHz	1	6	
	1 - OT	·				f _T : 3,5 MHz	1	6	
	NPN	Commutazione	V _{CEO} : 25 V	P ; 0,3 W		hFE : 30-90	2	4.5	
SFT713			VCBO : 25 V	Tj : 175 °C		fy : 300 MHz	10	5	
	TO - 18		Ic : 0,2 A	R _{thc} : 150 °C/W					

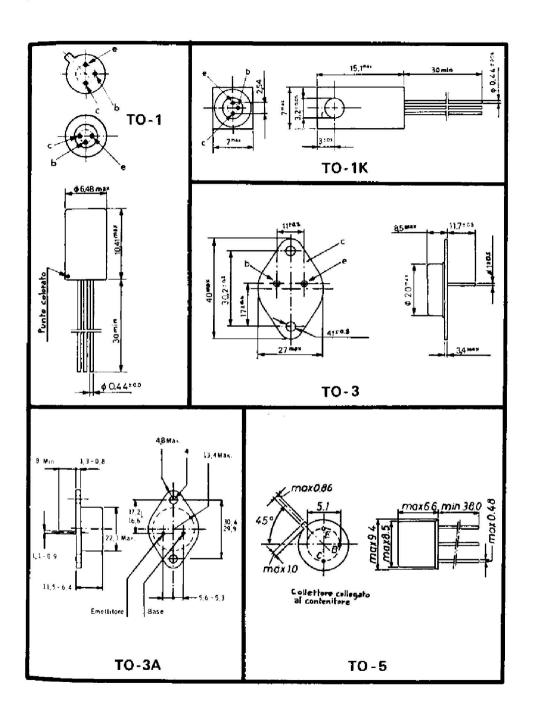
* * * * *

#### CONTENITORI

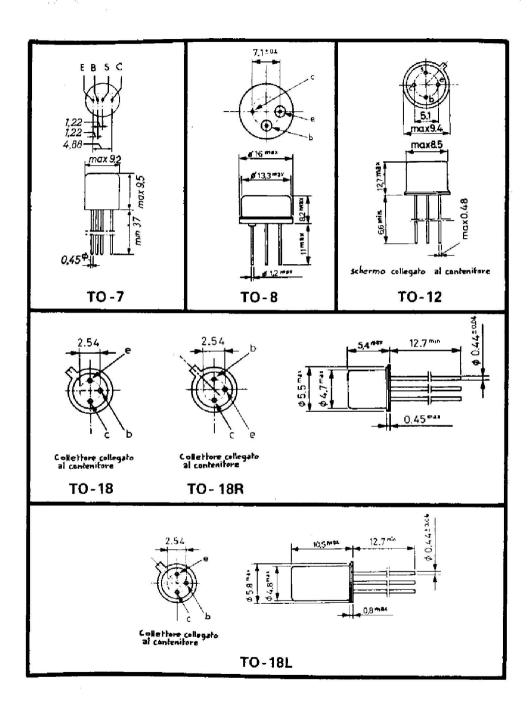
(dimensioni in mm)

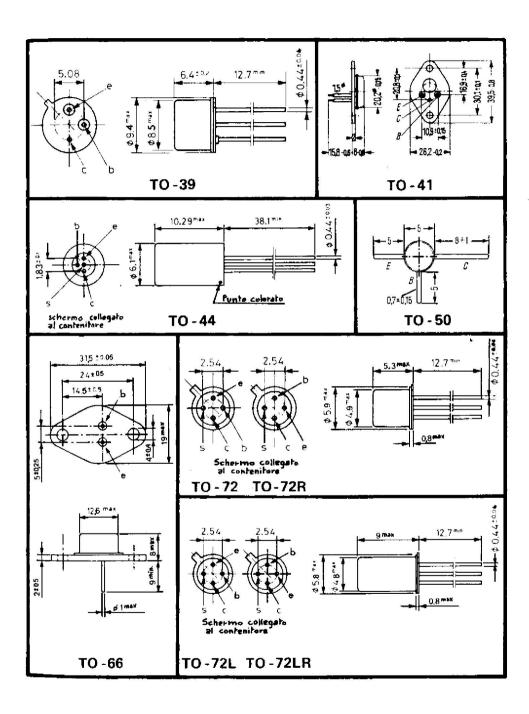


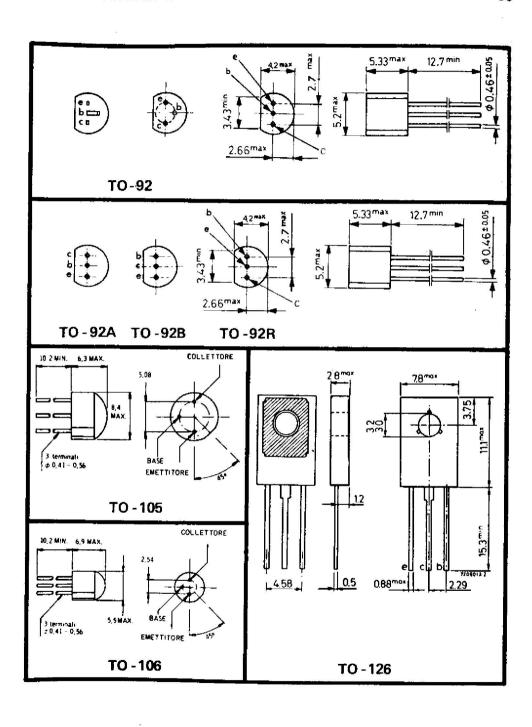


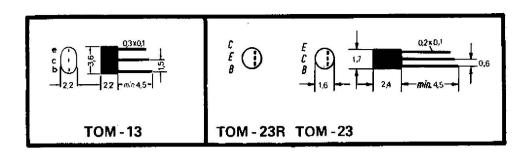






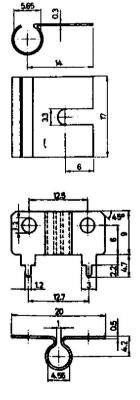






#### ALETTE DI RAFFREDDAMENTO

(dimensioni in mm)



ALETTA Nº 1 (tipo Philips 56227)

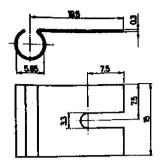
Resistenza termica Rthd = 100 °C/W

Materiale: ottone placcato in nichel

ALETTA Nº 2 (tipo Philips 56263)

Resistenza termica R_{thd} = 100 °C/W

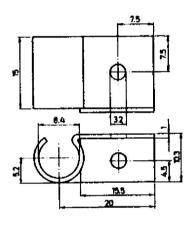
Materiale: rame placcato in stagno



# ALETTA Nº 3 (tipo Philips 56200)

Materiale: ottone placcato in nichel

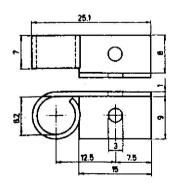
Resistenza termica R_{thd} = 100 °C/W



#### ALETTA Nº 4 (tipo Philips 56207)

Materiale: alluminio brunito

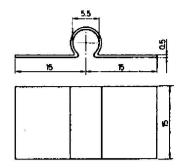
Resistenza termica R_{thd} = 60 °C/W



# ALETTA Nº 5 (tipo Philips 56265)

Materiale: alluminio brunito

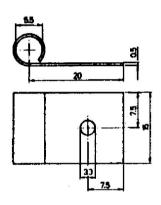
Resistenza termica R_{thd} = 80 °C/W



# ALETTA Nº 6 (tipo Philips 56209)

Materiale: ottone placcato in nichel

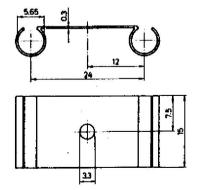
Resistenza termica Rthd = 75 °C/W



### ALETTA Nº 7 (tipo Philips 56210)

Materiale: ottone placcato in nichel

Resistenza termica R_{thd} = 95 °C/W



ALETTA Nº 8 (tipo Philips 56208)

Materiale: ottone placcato in nichel

Resistenza termica R_{thd} = 102 °C/W